

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第5462251号
(P5462251)

(45) 発行日 平成26年4月2日(2014.4.2)

(24) 登録日 平成26年1月24日(2014.1.24)

(51) Int.Cl.	F I
HO 1 L 51/50 (2006.01)	HO 5 B 33/14 A
HO 5 B 33/22 (2006.01)	HO 5 B 33/22 Z
HO 5 B 33/12 (2006.01)	HO 5 B 33/12 B
HO 5 B 33/10 (2006.01)	HO 5 B 33/10
HO 5 B 33/24 (2006.01)	HO 5 B 33/24

請求項の数 27 (全 49 頁)

(21) 出願番号 特願2011-514927 (P2011-514927)
 (86) (22) 出願日 平成22年8月6日(2010.8.6)
 (86) 国際出願番号 PCT/JP2010/004990
 (87) 国際公開番号 W02012/017500
 (87) 国際公開日 平成24年2月9日(2012.2.9)
 審査請求日 平成25年1月8日(2013.1.8)

(73) 特許権者 000005821
 パナソニック株式会社
 大阪府門真市大字門真1006番地
 (74) 代理人 100090446
 弁理士 中島 司朗
 (74) 代理人 100125597
 弁理士 小林 国人
 (74) 代理人 100146798
 弁理士 川畑 孝二
 (74) 代理人 100121027
 弁理士 木村 公一
 (72) 発明者 西山 誠司
 大阪府門真市大字門真1006番地 パナ
 ソニック株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機EL表示パネル、表示装置、及び有機EL表示パネルの製造方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

TFT層と、
 前記TFT層の上方に設けられた層間絶縁膜と、
 前記層間絶縁膜上に形成され、ライン状に配列された複数の第1色用の電極板を含む第1電極板群と、
 前記層間絶縁膜上に前記第1電極板群と隣接して形成され、ライン状に配列された複数の第2色用の電極板を含む第2電極板群と、
 前記第1電極板群の一方の長辺部分に沿って形成された第1隔壁と、
 前記第1電極板群の他方の長辺部分と、前記第2電極板群の一方の長辺部分との間に形成された第2隔壁と、
 前記第2電極板群の他方の長辺部分に沿って形成された第3隔壁と、
 前記第1隔壁と前記第2隔壁との間において前記第1電極板群の上方に形成された第1有機機能層と、
 前記第2隔壁と前記第3隔壁との間において前記第2電極板群の上方に形成された第2有機機能層と、
 前記第1有機機能層及び前記第2有機機能層の上方に設けられた対向電極と、
 を具備し、
 前記層間絶縁膜には、前記第1色用の電極板の各々とTFT層とを接続する第1コンタクトホール、及び、前記第2色用の電極板の各々とTFT層とを接続する第2コンタクト

10

20

ホールが設けられ、

前記第 1 色用の電極板の各々は、前記第 1 コンタクトホールの形状に沿って窪む第 1 窪み部を有し、前記第 2 色用の電極板の各々は、前記第 2 コンタクトホールの形状に沿って窪む第 2 窪み部を有しており、

前記層間絶縁膜の厚みは、前記第 1 電極板群が形成された箇所が、前記第 2 電極板群が形成された箇所より厚く形成されており、

前記第 1 コンタクトホールは、前記第 2 コンタクトホールより深く、かつ、容積が大きく、

前記第 1 色用の電極板上の領域に対応する前記第 1 有機機能層の体積は、前記第 2 色用の電極板上の領域に対応する前記第 2 有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、

前記第 1 有機機能層の膜厚は、前記第 1 コンタクトホールに対応する第 1 窪み部に入り込む前記第 1 有機機能層の量が前記第 2 コンタクトホールに対応する第 2 窪み部に入り込む前記第 2 有機機能層の量より多いことにより、前記第 1 窪み部以外の前記第 1 色用の電極板上の領域において、前記第 2 窪み部以外の前記第 2 色用の電極板上の領域に形成された前記第 2 有機機能層の膜厚より薄い、

有機 E L 表示パネル。

【請求項 2】

前記第 1 色用の電極板に対応する第 1 コンタクトホールの上面積と前記第 2 色用の電極板に対応する第 2 コンタクトホールの上面積とは、同一又は同一の近傍値の範囲内である

請求項 1 に記載の有機 E L 表示パネル。

【請求項 3】

前記第 1 コンタクトホールおよび前記第 2 コンタクトホールの各コンタクトホールの上面積は、前記層間絶縁膜における前記各コンタクトホールの周縁部のもっとも高い位置から 10%、又は 10% の近傍値の範囲内に下がった位置における前記各コンタクトホールの直径で規定される円の面積である、

請求項 2 に記載の有機 E L 表示パネル。

【請求項 4】

前記第 1 コンタクトホールに対応する前記第 1 窪み部は、第 1 画素規制層により覆われ、前記第 1 画素規制層の上方に第 1 有機機能層が形成され、

前記第 2 コンタクトホールに対応する前記第 2 窪み部は、第 2 画素規制層により覆われ、前記第 2 画素規制層の上方に第 2 有機機能層が形成されている、

請求項 1 ないし請求項 3 のいずれか 1 項に記載の有機 E L 表示パネル。

【請求項 5】

前記第 1 有機機能層は、インクジェット式塗布方法により所定の体積の液滴が塗布されることにより、前記第 1 電極板群の上方に連続して形成され、

前記第 2 有機機能層は、インクジェット式塗布方法により前記所定の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内の体積の液滴が塗布されることにより前記第 2 電極板群の上方に連続して形成され、

前記第 1 色用の電極板上の領域に対応する前記第 1 有機機能層の体積は、前記第 2 色用の電極板上の領域に対応する前記第 2 有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内である、

請求項 1 乃至請求項 4 のいずれか 1 記載の有機 E L 表示パネル。

【請求項 6】

前記第 1 有機機能層の膜厚と前記第 2 有機機能層の膜厚との差は、前記インクジェット式塗布方法により前記所定の体積の液滴が塗布される場合、前記第 1 色用の電極板ごとに塗布される前記液滴数が、 n 滴増加することにより形成される前記第 1 有機機能層の膜厚より大きく、前記液滴数が $n + 1$ 滴増加することにより形成される前記第 1 有機機能層の膜厚より小さい、

10

20

30

40

50

請求項 5 記載の有機 E L 表示パネル。

【請求項 7】

前記第 1 色は青色である、

請求項 1 乃至請求項 6 のいずれか 1 項に記載の有機 E L 表示パネル。

【請求項 8】

前記層間絶縁膜の上面は、前記第 1 電極板群が形成された箇所が、前記第 2 電極板群が形成された箇所より高く形成されており、

前記 T F T 層は、前記第 1 コンタクトホール of 底面に対応する箇所と、前記第 2 コンタクトホール of 底面に対応する箇所とが同一又は同一の近傍値の範囲内の高さに形成されている、

10

請求項 1 ないし請求項 7 のいずれか 1 項に記載の有機 E L 表示パネル。

【請求項 9】

前記層間絶縁膜の上面は、前記第 1 電極板群が形成された箇所と、前記第 2 電極板群が形成された箇所とが同一又は同一の近傍値の範囲内の高さに形成されており、

前記 T F T 層は、前記第 1 コンタクトホール of 底面に対応する箇所が、前記第 2 コンタクトホール of 底面に対応する箇所よりも低く形成されている、

請求項 1 ないし請求項 7 のいずれか 1 項に記載の有機 E L 表示パネル。

【請求項 10】

前記第 2 電極板群と隣接して形成され、ライン状に配列された複数の第 3 色用の電極板を含む第 3 電極板群と、

20

前記第 3 電極板群の前記第 2 電極板群と反対側の長辺部分に沿って形成された第 4 隔壁と、

前記第 3 隔壁と前記第 4 隔壁との間において前記第 3 電極板群の上方に形成された第 3 有機機能層と、

を含み、

前記対向電極は、前記第 3 有機機能層の上方に設けられ、

前記層間絶縁膜には、前記第 3 色用の電極板の各々と T F T 層とを接続する第 3 コンタクトホールが設けられ、

前記第 3 色用の電極板は、前記第 3 コンタクトホール of 形状に沿って窪む第 3 窪み部を有しており、

30

前記層間絶縁膜は、前記第 1 電極板群が形成された箇所が、前記第 3 電極板群が形成された箇所より厚く形成されており、

前記第 1 コンタクトホールは、前記第 3 コンタクトホールより深く、かつ、容積が大きく、

前記第 1 色用の電極板上の領域に対応する前記第 1 有機機能層の体積は、前記第 3 色用の電極板上の領域に対応する前記第 3 有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、

前記第 1 有機機能層の膜厚は、前記第 1 コンタクトホールに対応する第 1 窪み部に入り込む前記第 1 有機機能層の量が前記第 3 コンタクトホールに対応する第 3 窪み部に入り込む前記第 3 有機機能層の量より多いことにより、前記第 1 窪み部以外の前記第 1 色用の電極板上の領域において、前記第 3 窪み部以外の前記第 3 色用の電極板上の領域に形成された前記第 3 有機機能層の膜厚より薄い、

40

請求項 1 記載の有機 E L 表示パネル。

【請求項 11】

前記第 1 色用の電極板に対応する第 1 コンタクトホール of 上面積、前記第 2 色用の電極板に対応する第 2 コンタクトホール of 上面積及び前記第 3 色用の電極板に対応する第 3 コンタクトホール of 上面積とは、同一又は同一の近傍値の範囲内である、

請求項 10 記載の有機 E L 表示パネル。

【請求項 12】

前記第 1 コンタクトホールおよび前記第 2 コンタクトホール of 各コンタクトホール of 上

50

面積は、前記層間絶縁膜における前記各コンタクトホール¹⁰の周縁部のもっとも高い位置から10%又は10%の近傍値の範囲内に下がった位置における前記各コンタクトホール¹⁰の直径で規定される円の面積である、

請求項11に記載の有機EL表示パネル。

【請求項13】

前記層間絶縁膜の上面は、前記第1電極板群が形成された箇所が、前記第2電極板群が形成された箇所及び前記第3電極板群が形成された箇所より高く形成されており、

前記TFT層は、前記第1コンタクトホールの底面に対応する箇所、前記第2コンタクトホールの底面に対応する箇所、及び前記第3コンタクトホールの底面に対応する箇所が同一又は同一の近傍値の範囲内の高さに形成されている、

請求項10ないし請求項12のいずれか1項に記載の有機EL表示パネル。

【請求項14】

前記層間絶縁膜の上面は、前記第1電極板群が形成された箇所、前記第2電極板群が形成された箇所、及び前記第3電極板群が形成された箇所が同一又は同一の近傍値の範囲内の高さに形成されており、

前記TFT層は、前記第1コンタクトホールの底面に対応する箇所が、前記第2コンタクトホールの底面に対応する箇所及び前記第3コンタクトホールの底面に対応する箇所よりも低く形成されている、

請求項10ないし請求項12のいずれか1項に記載の有機EL表示パネル。

【請求項15】

前記第1有機機能層及び前記第2有機機能層は、電荷注入層、あるいは電荷輸送層のいずれかであり、

前記第1有機機能層と前記対向電極との間に第1有機発光層が形成され、前記第2有機機能層と前記対向電極との間に第2有機発光層が形成されている、

請求項1ないし請求項9のいずれか1項に記載の有機EL表示パネル。

【請求項16】

前記第1有機機能層、前記第2有機機能層、及び前記第3有機機能層は、電荷注入層あるいは電荷輸送層のいずれかであり、

前記第1有機機能層と前記対向電極との間に第1有機発光層が形成され、前記第2有機機能層と前記対向電極との間に第2有機発光層が形成され、前記第3有機機能層と前記対向電極との間に第3有機発光層が形成されている、

請求項10ないし請求項14のいずれか1項に記載の有機EL表示パネル。

【請求項17】

前記第1有機機能層及び前記第2有機機能層は、有機発光層である、

請求項1ないし請求項9のいずれか1項に記載の有機EL表示パネル。

【請求項18】

前記第1有機機能層、前記第2有機機能層、及び前記第3有機機能層は、有機発光層である、

請求項10ないし請求項14のいずれか1項に記載の有機EL表示パネル。

【請求項19】

前記第1色用の電極板および前記第2色用の電極板の各電極板は陽極であり、前記対向電極は陰極である、

請求項1ないし請求項18のいずれか1項に記載の有機EL表示パネル。

【請求項20】

前記第1色用の電極板および前記第2色用の電極板の各電極板は陰極であり、前記対向電極は陽極である、

請求項1ないし請求項18のいずれか1項に記載の有機EL表示パネル。

【請求項21】

請求項1ないし請求項20のいずれか1項に記載の有機EL表示パネルを備えた、表示装置。

【請求項 2 2】

基板を準備する第 1 工程と、
前記基板上に T F T 層を形成する第 2 工程と、
前記 T F T 層上に層間絶縁膜を形成する第 3 工程と、
複数の第 1 色用の電極板をライン状に配列した第 1 電極板群を前記層間絶縁膜上に形成し、前記第 1 電極板群と隣接して複数の第 2 色用の電極板をライン状に配列した第 2 電極板群を前記層間絶縁膜上に形成する第 4 工程と、
前記第 1 電極板群の一方の長辺部分に沿って第 1 隔壁を形成し、前記第 1 電極板群の他方の長辺部分と前記第 2 電極板群の一方の長辺部分との間に第 2 隔壁を形成し、前記第 2 電極板群の他方の長辺部分に沿って第 3 隔壁を形成する第 5 工程と、
前記第 1 隔壁と前記第 2 隔壁との間において前記第 1 電極板群の上方に連続して第 1 有機機能層を形成する第 6 工程と、
前記第 2 隔壁と前記第 3 隔壁との間において前記第 2 電極板群の上方に連続して第 2 有機機能層を形成する第 7 工程と、
前記第 1 有機機能層及び前記第 2 有機機能層の上方に対向電極を設ける第 8 工程と、
を具備し、
前記第 3 工程において、
前記層間絶縁膜の厚みは、前記第 1 電極板群が形成された箇所が、前記第 2 電極板群が形成された箇所より厚く形成されており、
前記層間絶縁膜には、前記第 1 色用の電極板の各々と T F T 層とを接続する第 1 コンタクトホール、及び、前記第 2 色用の電極板の各々と T F T 層とを接続する第 2 コンタクトホールが設けられ、
前記第 1 コンタクトホールは、前記第 2 コンタクトホールより深く、かつ、容積が大きく形成され、
前記第 4 工程において、
前記第 1 色用の電極板の各々には、前記第 1 コンタクトホールの形状に沿って第 1 窪み部が形成され、前記第 2 色用の電極板の各々には、前記第 2 コンタクトホールの形状に沿って第 2 窪み部が形成され、
前記第 6 工程で形成された前記第 1 有機機能層及び前記第 7 工程で形成された前記第 2 有機機能層において、
前記第 1 色用の電極板上の領域に対応する前記第 1 有機機能層の体積は、前記第 2 色用の電極板上の領域に対応する前記第 2 有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、
前記第 1 有機機能層の膜厚は、前記第 1 コンタクトホールに対応する第 1 窪み部に入り込む前記第 1 有機機能層の量が前記第 2 コンタクトホールに対応する第 2 窪み部に入り込む前記第 2 有機機能層の量より多いことにより、前記第 1 窪み部以外の前記第 1 色用の電極板上の領域において、前記第 2 窪み部以外の前記第 2 色用の電極板上の領域に形成された前記第 2 有機機能層の膜厚より薄い、
有機 E L 表示パネルの製造方法。

【請求項 2 3】

前記第 1 色用の電極板に対応するコンタクトホールの上面積と前記第 2 色用の電極板に対応するコンタクトホールの上面積とは、同一又は同一の近傍値の範囲内である、
請求項 2 2 記載の有機 E L 表示パネルの製造方法。

【請求項 2 4】

前記第 4 工程と前記第 5 工程との間に、前記第 1 コンタクトホールに対応する前記第 1 窪み部を覆うように第 1 画素規制層を形成し、前記第 2 コンタクトホールに対応する前記第 2 窪み部を覆うように第 2 画素規制層を形成する工程を設け、
前記第 6 工程において、前記第 1 画素規制層の上方に前記第 1 有機機能層が形成され、
前記第 7 工程において、前記第 2 画素規制層の上方に前記第 2 有機機能層が形成される、

10

20

30

40

50

請求項 2 2 又は請求項 2 3 に記載の有機 E L 表示パネルの製造方法。

【請求項 2 5】

前記第 6 工程において、前記第 1 有機機能層は、インクジェット式塗布方法により所定の体積の液滴を塗布することにより、前記第 1 電極板群の上方に連続して形成し、

前記第 7 工程において、前記第 2 有機機能層は、インクジェット式塗布方法により前記所定の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内の体積の液滴を塗布することにより、前記第 2 電極板群の上方に連続して形成される、

請求項 2 2 乃至請求項 2 4 のいずれか 1 項に記載の有機 E L 表示パネルの製造方法。

【請求項 2 6】

前記第 1 有機機能層の膜厚と前記第 2 有機機能層の膜厚との差は、前記インクジェット式塗布方法により前記所定の体積の液滴が塗布される場合、前記第 1 色用の電極板ごとに塗布される液滴数が、 n 滴増加することによる前記第 1 有機機能層の膜厚の増加分より大きく、前記液滴数が $n + 1$ 滴増加することによる前記第 1 有機機能層の膜厚の増加分より小さい、

請求項 2 5 記載の有機 E L 表示パネルの製造方法。

【請求項 2 7】

基板を準備する第 1 工程と、

前記基板上に T F T 層を形成する第 2 工程と、

前記 T F T 層上に層間絶縁膜を形成する第 3 工程と、

複数の第 1 色用の電極板をライン状に配列した第 1 電極板群を前記層間絶縁膜上に形成し、前記第 1 電極板群と隣接して複数の第 2 色用の電極板をライン状に配列した第 2 電極板群を前記層間絶縁膜上に形成し、前記第 2 電極板群と隣接して複数の第 3 色用の電極板をライン状に配列した第 3 電極板群を前記層間絶縁膜上に形成する第 4 工程と、

前記第 1 電極板群の一方の長辺部分に沿って第 1 隔壁を形成し、前記第 1 電極板群の他方の長辺部分と前記第 2 電極板群の一方の長辺部分との間に第 2 隔壁を形成し、前記第 2 電極板群の他方の長辺部分と前記第 3 電極板群の一方の長辺部分との間に第 3 隔壁を形成し、前記第 3 電極板群の他方の長辺部分に沿って第 4 隔壁を形成する第 5 工程と、

前記第 1 隔壁と前記第 2 隔壁との間において前記第 1 電極板群の上方に連続して第 1 有機機能層を形成する第 6 工程と、

前記第 2 隔壁と前記第 3 隔壁との間において前記第 2 電極板群の上方に連続して第 2 有機機能層を形成する第 7 工程と、

前記第 3 隔壁と前記第 4 隔壁との間において前記第 3 電極板群の上方に連続して第 3 有機機能層を形成する第 8 工程と、

前記第 1 有機機能層、前記第 2 有機機能層及び前記第 3 有機機能層の上方に対向電極を形成する第 9 工程と、

を具備し、

前記第 3 工程において、

前記層間絶縁膜の厚みは、前記第 1 電極板群が形成された箇所が、前記第 2 電極板群が形成された箇所及び前記第 3 電極板群が形成された箇所より厚く形成されており、

前記層間絶縁膜には、前記第 1 色用の電極板の各々と T F T 層とを接続する第 1 コンタクトホール、前記第 2 色用の電極板の各々と T F T 層とを接続する第 2 コンタクトホール、及び、前記第 3 色用の電極板の各々と T F T 層とを接続する第 3 コンタクトホールが設けられ、

前記第 1 コンタクトホールの深さは、前記第 2 コンタクトホール及び前記第 3 コンタクトホールより深く、かつ、容積が大きく形成され、

前記第 4 工程において、

前記第 1 色用の電極板の各々には、前記第 1 コンタクトホールの形状に沿って第 1 窪み部が形成され、前記第 2 色用の電極板の各々には、前記第 2 コンタクトホールの形状に沿って第 2 窪み部が形成され、前記第 3 色用の電極板の各々には、前記第 3 コンタクトホールの形状に沿って第 3 窪み部が形成され、

10

20

30

40

50

前記第 6 工程、前記第 7 工程及び前記第 8 工程でそれぞれ形成された前記第 1 有機機能層、前記第 2 有機機能層及び前記第 3 有機機能層において、

前記第 1 色用の電極板上の領域に対応する前記第 1 有機機能層の体積は、前記第 2 色用の電極板上の領域に対応する前記第 2 有機機能層の体積及び前記第 3 色用の電極板上の領域に対応する前記第 3 有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、

前記第 1 有機機能層の膜厚は、前記第 1 コンタクトホールに対応する第 1 窪み部に入り込む前記第 1 有機機能層の量が、前記第 2 コンタクトホールに対応する第 2 窪み部に入り込む前記第 2 有機機能層の量及び前記第 3 コンタクトホールに対応する第 3 窪み部に入り込む前記第 3 有機機能層の量より多いことにより、前記第 1 窪み部以外の前記第 1 色用の電極板上の領域において、前記第 2 窪み部以外の前記第 2 色用の電極板上の領域に形成された前記第 2 有機機能層の膜厚及び前記第 3 窪み部以外の前記第 3 色用の電極板上の領域に形成された前記第 3 有機機能層の膜厚より薄い、
有機 E L 表示パネルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機電界発光素子（以下「有機 E L 素子」と称する）を配列した有機 E L 表示パネル、表示装置、及び有機 E L 表示パネルの製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

近年、発光型の表示パネルとして、基板上に行列方向に沿って有機 E L 素子を複数配列した有機 E L 表示パネルが、小型電子機器や小型の表示装置に用いられている。有機 E L 素子は、陽極と陰極の一对の電極対の間に有機発光材料を含む発光層が形成された基本構造を有している。有機 E L 素子は、一对の電極対間に電圧が印加されると、陽極から発光層に注入されるホールと、陰極から発光層に注入される電子との再結合に伴って光を発する。この有機 E L 表示パネルは、各有機 E L 素子が自己発光を行うので視認性が高い。

【0003】

有機 E L 表示パネルにおいて、一般に発光層は、有機 E L 素子ごとに絶縁材料からなる隔壁（バンク）で仕切られていて、この隔壁によって発光層の形成領域が規定されている。また、陽極と発光層との間には、ホール注入層、ホール輸送層、ホール注入兼輸送層といった中間層が必要に応じて介挿される。また、陰極と発光層との間にも、必要に応じて電子注入層、電子輸送層または電子注入兼輸送層が介挿される。

【0004】

フルカラー表示の有機 E L 表示パネルにおいては、このような有機 E L 素子が、RGB（赤緑青）各色のサブピクセルを形成し、隣り合う RGB のサブピクセルが合わさって一画素が形成されている。

【0005】

各有機 E L 素子の発光層や中間層を形成する方法には、隣接する各有機 E L 素子同士を仕切る隔壁を基板上に形成しておいて、高分子材料や薄膜形成性の良い低分子材料を含むインクを、インクジェット等で塗布するウェット方式が多く用いられている。このウェット方式によれば、大型のパネルにおいても中間層や発光層を比較的容易に形成することができる。

【0006】

ウェット方式のうちの代表的なインクジェット方式では、例えば、塗布対象の基板の上方を行列方向のいずれかの方向にインクジェットヘッドを移動させ、基板上の隔壁で区画された領域に、中間層、発光層などを形成するための有機材料と溶媒とを含む溶液（以下、単に「インク」と称する。）の液滴をノズルから吐出させてインクを塗布する（特許文献 1 参照）。

【先行技術文献】

【特許文献】

10

20

30

40

50

【0007】

【特許文献1】特開2003-241683号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

ところで、各有機EL素子の発光効率を高めるのに適した中間層の膜厚は、発光色の波長に依存する。例えば、トップエミッション型の有機EL素子では、発光層から基板側に放射された光が、一旦基板側の電極等によって反射させられた後、発光層を通過して出射する反射光と、発光層から直接上方（基板と反対側）へ出射する光とが強め合うように光路長が設定されていることが望ましい。

10

【0009】

すなわち、赤色光と緑色光と青色光では、その波長の違いにより、有機EL素子内での最適な光路長（共振条件）が異なるので、各色サブピクセルにおいて、発光色の波長に合わせて中間層の膜厚差を微調節することが発光効率を高める上で望ましい。

【0010】

しかし、実際にウェット方式で中間層を形成するときには、色ごとに中間層の膜厚を微調節することは實際上難しい。

具体的には、中間層の材料を含むインクは全ての色で共通とし、各サブピクセルに対して供給する中間層形成用のインク量を一定にしている。例えば、インクジェット方式で中間層のインクを塗布する場合、各色の有機EL素子を形成する領域に対して吐出するインクの液滴数は共通とし、且つノズルから吐出されるインク一滴あたりの体積も同じにしながら行っている。

20

【0011】

ここで、インクジェット方式の場合、サブピクセルの色ごとに滴下するインク液滴数を変更することによって中間層の膜厚を調節することも考えられるが、各サブピクセルに供給するインク量は、インク液滴単位でしか変更することはできないので、やはり、サブピクセルの色ごとに中間層の膜厚を微調節することは實際上難しい。

【0012】

また、発光層については、例えば、所望の輝度や色度を得るための適切な膜厚が色ごとに異なるため、異なる色に対応する発光層間の膜厚差を微調節すること、あるいは中間層と同様に光路長を発光色の波長に適したものとするために膜厚差を微調節することが求められている。

30

【0013】

以上に述べた例から分かるように、有機EL表示パネルにおいて、ウェット方式で中間層や発光層を形成する場合に、それらの膜厚差を微調節することが求められている。

本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであって、有機EL表示パネルにおいて、中間層又は発光層をウェット方式で形成しながら、異なる発光色間の中間層等の膜厚差を容易に微調節できるようにし、例えば、発光効率、発光色等を向上させることを目的とする。

【課題を解決するための手段】

40

【0014】

上記課題を解決するために、本発明の一態様における有機EL表示パネルでは、TF T層と、前記TF T層の上方に設けられた層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜上に形成され、ライン状に配列された複数の第1色用の電極板を含む第1電極板群と、前記層間絶縁膜上に前記第1電極板群と隣接して形成され、ライン状に配列された複数の第2色用の電極板を含む第2電極板群と、前記第1電極板群の一方の長辺部分に沿って形成された第1隔壁と、前記第1電極板群の他方の長辺部分と、前記第2電極板群の一方の長辺部分との間に形成された第2隔壁と、前記第2電極板群の他方の長辺部分に沿って形成された第3隔壁と、前記第1隔壁と前記第2隔壁との間において前記第1電極板群の上方に形成された第1有機機能層と、前記第2隔壁と前記第3隔壁との間において前記第2電極板群の上方に形

50

成された第2有機機能層と、前記第1有機機能層及び前記第2有機機能層の上方に設けられた対向電極と、を具備し、前記層間絶縁膜には、前記第1色用の電極板の各々とTFT層とを接続する第1コンタクトホール、及び、前記第2色用の電極板の各々とTFT層とを接続する第2コンタクトホールが設けられ、前記第1色用の電極板の各々は、前記第1コンタクトホールの形状に沿って窪む第1窪み部を有し、前記第2色用の電極板の各々は、前記第2コンタクトホールの形状に沿って窪む第2窪み部を有しており、前記層間絶縁膜の厚みは、前記第1電極板群が形成された箇所が、前記第2電極板群が形成された箇所より厚く形成されており、前記第1コンタクトホールは、前記第2コンタクトホールより深く、かつ、容積が大きく、前記第1色用の電極板上の領域に対応する前記第1有機機能層の体積は、前記第2色用の電極板上の領域に対応する前記第2有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、前記第1有機機能層の膜厚は、前記第1コンタクトホールに対応する第1窪み部に入り込む前記第1有機機能層の量が前記第2コンタクトホールに対応する第2窪み部に入り込む前記第2有機機能層の量より多いことにより、前記第1窪み部以外の前記第1色用の電極板上の領域において、前記第2窪み部以外の前記第2色用の電極板上の領域に形成された前記第2有機機能層の膜厚より薄い、という構成が採用されている。

10

【0015】

本発明の一態様における表示装置は、上記有機EL表示パネルを備えている。

本発明の一態様における有機EL表示パネルの製造方法では、基板を準備する第1工程と、前記基板上にTFT層を形成する第2工程と、前記TFT層上に層間絶縁膜を形成する第3工程と、複数の第1色用の電極板をライン状に配列した第1電極板群を前記層間絶縁膜上に形成し、前記第1電極板群と隣接して複数の第2色用の電極板をライン状に配列した第2電極板群を前記層間絶縁膜上に形成する第4工程と、前記第1電極板群の一方の長辺部分に沿って第1隔壁を形成し、前記第1電極板群の他方の長辺部分と前記第2電極板群の一方の長辺部分との間に第2隔壁を形成し、前記第2電極板群の他方の長辺部分に沿って第3隔壁を形成する第5工程と、前記第1隔壁と前記第2隔壁との間において前記第1電極板群の上方に連続して第1有機機能層を形成する第6工程と、前記第2隔壁と前記第3隔壁との間において前記第2電極板群の上方に連続して第2有機機能層を形成する第7工程と、前記第1有機機能層及び前記第2有機機能層の上方に対向電極を設ける第8工程と、を具備し、前記第3工程において、前記層間絶縁膜の厚みは、前記第1電極板群が形成された箇所が、前記第2電極板群が形成された箇所より厚く形成されており、前記層間絶縁膜には、前記第1色用の電極板の各々とTFT層とを接続する第1コンタクトホールと、前記第2色用の電極板の各々とTFT層とを接続する第2コンタクトホールとが設けられ、前記第1コンタクトホールは、前記第2コンタクトホールより深く、かつ、容積が大きく形成され、前記第4工程において、前記第1色用の電極板の各々には、前記第1コンタクトホールの形状に沿って第1窪み部が形成され、前記第2色用の電極板の各々には、前記第2コンタクトホールの形状に沿って第2窪み部が形成され、前記第6工程で形成された前記第1有機機能層及び前記第7工程で形成された前記第2有機機能層において、前記第1色用の電極板上の領域に対応する前記第1有機機能層の体積は、前記第2色用の電極板上の領域に対応する前記第2有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、前記第1有機機能層の膜厚は、前記第1コンタクトホールに対応する第1窪み部に入り込む前記第1有機機能層の量が前記第2コンタクトホールに対応する第2窪み部に入り込む前記第2有機機能層の量より多いことにより、前記第1窪み部以外の前記第1色用の電極板上の領域において、前記第2窪み部以外の前記第2色用の電極板上の領域に形成された前記第2有機機能層の膜厚より薄い、という構成が採用されている。

20

30

40

【発明の効果】

【0016】

本発明の一態様における有機EL表示パネルによれば、層間絶縁膜の厚みを異ならせることで第1コンタクトホールと第2コンタクトホールとの深さを変えることができ、容易に第1コンタクトホールの容積(体積)を第2コンタクトホールの容積(体積)より大き

50

くすることができる。

【0017】

そのため、第1窪み部の容積が第2窪み部の容積よりも大きくなり、ウェット方式による有機機能層の形成において、例えば、電極板の上方に形成された第1有機機能層と第2有機機能層とが同体積である場合に、第1窪み部に入り込む第1有機機能層の量を、第2窪み部に入り込む第2有機機能層の量より多くすることができる。その結果、例えば、第1色用の電極板および第2色用の電極板の上方に同体積の有機機能層を形成した場合に、第1色用の電極板の第1窪み部以外の領域（例えば、平坦な領域）に対応する第1有機機能層の膜厚（以下、単に第1有機機能層の膜厚という）を、第2色用の電極板の第2窪み部以外の領域に対応する第2有機機能層の膜厚（以下、単に第2有機機能層の膜厚という）より薄くすることができる。

10

【0018】

ここで、第1窪み部の容積と第2窪み部の容積との差は、インクジェット式塗布方法においてノズルから吐出するインク一滴あたりの体積よりも小さい単位で調節が可能である。そのため、第1窪み部の容積と第2窪み部の容積との差を微調節することによって、第1有機機能層の膜厚と、第2有機機能層の膜厚との差を容易に微調節することができる。

【0019】

よって、異なる色に対応する有機機能層の膜厚差を微調節し易くなる。その結果、例えば、有機EL素子内での光の共振条件を色ごとに適切化でき、発光効率の優れた表示パネルを容易に得ることができる。

20

【0020】

なお、有機EL素子内での光の共振条件を色ごとに適切化するために、有機機能層だけで光路長を適切化する必要はなく、他の層（例えば、透明電極層）も色ごとに膜厚を調節することができる。

【0021】

ここで、「前記層間絶縁膜の厚みを、前記第1電極板群が形成された箇所が、前記第2電極板群が形成された箇所より厚く形成する」ために、第1電極板群が形成された箇所と、第2電極板群が形成された箇所とにおいて、層間絶縁膜の上面と下面との少なくとも一方の高さを変えることができる（詳細は後述する）。

【0022】

本発明の一態様における有機EL表示パネルの製造方法によれば、上述の有機EL表示パネルを製造することができる。

30

【図面の簡単な説明】

【0023】

【図1】実施の形態1に係る有機EL表示パネル100の構成を模式的に示す断面図である。

【図2】表示パネル100の概略構成を示す斜視図である。

【図3】(a)は表示パネル100の概略構成を示す平面図、(b)は(a)のA-A'線で切断した断面図、(c)は(a)のB-B'線で切断した断面図である。

【図4】表示パネル100の製造方法を説明するための図である。

40

【図5】表示パネル100の層間絶縁膜を形成する工程を説明するための模式図である。

【図6】表示パネル100の隔壁を形成する工程を説明するための模式図である。

【図7】基板上に中間層形成用のインクを塗布した直後及び乾燥後の様子を示す断面模式図である。

【図8】窪み部15の容積とホール輸送層9の膜厚との関係を説明するための模式図である。

【図9】コンタクトホール13の上面積を説明するための図である。

【図10】有機EL素子20内の光の進み方を説明するための模式図である。

【図11】実施の形態2に係る表示パネルの概略構成を示す断面図である。

【図12】実施の形態2に係る段付き基板81を形成する工程を説明するための模式図で

50

ある。

【図13】実施の形態に係る表示装置200の全体構成を示す図である。

【図14】表示装置200を用いたテレビシステムの一例を示す外観形状である。

【発明を実施するための形態】

【0024】

<発明の態様>

本発明の一態様における有機EL表示パネルでは、TFT層と、前記TFT層の上方に設けられた層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜上に形成され、ライン状に配列された複数の第1色用の電極板を含む第1電極板群と、前記層間絶縁膜上に前記第1電極板群と隣接して形成され、ライン状に配列された複数の第2色用の電極板を含む第2電極板群と、前記第1電極板群の一方の長辺部分に沿って形成された第1隔壁と、前記第1電極板群の他方の長辺部分と、前記第2電極板群の一方の長辺部分との間に形成された第2隔壁と、前記第2電極板群の他方の長辺部分に沿って形成された第3隔壁と、前記第1隔壁と前記第2隔壁との間において前記第1電極板群の上方に形成された第1有機機能層と、前記第2隔壁と前記第3隔壁との間において前記第2電極板群の上方に形成された第2有機機能層と、前記第1有機機能層及び前記第2有機機能層の上方に設けられた対向電極と、を具備し、前記層間絶縁膜には、前記第1色用の電極板の各々とTFT層とを接続する第1コンタクトホール、及び、前記第2色用の電極板の各々とTFT層とを接続する第2コンタクトホールが設けられ、前記第1色用の電極板の各々は、前記第1コンタクトホールの形状に沿って窪む第1窪み部を有し、前記第2色用の電極板の各々は、前記第2コンタクトホールの形状に沿って窪む第2窪み部を有しており、前記層間絶縁膜の厚みは、前記第1電極板群が形成された箇所が、前記第2電極板群が形成された箇所より厚く形成されており、前記第1コンタクトホールは、前記第2コンタクトホールより深く、かつ、容積が大きく、前記第1色用の電極板上の領域に対応する前記第1有機機能層の体積は、前記第2色用の電極板上の領域に対応する前記第2有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、前記第1有機機能層の膜厚は、前記第1コンタクトホールに対応する第1窪み部に入り込む前記第1有機機能層の量が前記第2コンタクトホールに対応する第2窪み部に入り込む前記第2有機機能層の量より多いことにより、前記第1窪み部以外の前記第1色用の電極板上の領域において、前記第2窪み部以外の前記第2色用の電極板上の領域に形成された前記第2有機機能層の膜厚より薄い、という構成が採用されている。

【0025】

本発明の一態様における有機EL表示パネルによれば、層間絶縁膜の厚みを異ならせることで第1コンタクトホールと第2コンタクトホールとの深さを変えることができ、容易に第1コンタクトホールの容積(体積)を第2コンタクトホールの容積(体積)より大きくすることができる。

【0026】

そのため、第1窪み部の容積が第2窪み部の容積よりも大きくなり、ウェット方式による有機機能層の形成において、例えば、電極板の上方に形成された第1有機機能層と第2有機機能層とが同体積である場合に、第1窪み部に入り込む第1有機機能層の量を、第2窪み部に入り込む第2有機機能層の量より多くすることができる。その結果、例えば、第1色用の電極板および第2色用の電極板の上方に同体積の有機機能層を形成した場合に、第1色用の電極板の第1窪み部以外の領域(例えば、平坦な領域、発光領域等)に対応する第1有機機能層の膜厚(以下、単に第1有機機能層の膜厚という)を、第2色用の電極板の第2窪み部以外の領域に対応する第2有機機能層の膜厚(以下、単に第2有機機能層の膜厚という)より薄くすることができる。

【0027】

ここで、第1窪み部の容積と第2窪み部の容積との差は、インクジェット式塗布方法においてノズルから吐出するインク一滴あたりの体積よりも小さい単位で調節が可能である。そのため、第1窪み部の容積と第2窪み部の容積との差を微調節することによって、第1有機機能層の膜厚と、第2有機機能層の膜厚との差を容易に微調節することができる。

【 0 0 2 8 】

よって、異なる色に対応する有機機能層の膜厚差を微調節し易くなる。その結果、例えば、有機 E L 素子内での光の共振条件を色ごとに適切化でき、発光効率の優れた表示パネルを容易に得ることができる。

【 0 0 2 9 】

なお、有機 E L 素子内での光の共振条件を色ごとに適切化するために、有機機能層だけで光路長を適切化する必要はなく、他の層（例えば、透明電極層）も色ごとに膜厚を調節することができる。

【 0 0 3 0 】

ここで、有機 E L 素子内での光の共振条件が色ごとに適切化されているとは、例えば、仮に、本態様の有機 E L 表示パネルと同じ製造条件（有機 E L 素子の寸法、インク塗布量等の条件）で、第 1 及び第 2 コンタクトホールを同じにして有機 E L 表示パネルを製造するとした場合に、第 1 色用及び第 2 色用の有機 E L 素子の両方の発光効率を向上させることは両立できないが、第 1 及び第 2 コンタクトホールの容積を異ならせることで両立させている状態をいう。

10

【 0 0 3 1 】

なお、仮に第 1 及び第 2 コンタクトホールの容積を同じにした場合に、第 1 色用及び第 2 色用の有機 E L 素子の両方の発光効率を向上させることが両立できない状態の具体例としては、仮に本態様の有機 E L 表示パネルの第 1 コンタクトホールの容積を小さくして第 2 コンタクトホールの容積と同じにした場合に、第 1 色用の有機 E L 素子の発光効率が低下し、他方、仮に第 2 コンタクトホールの容積を大きくして第 1 コンタクトホールの容積と同じにした場合に、第 2 色用の有機 E L 素子の発光効率が低下する、などといった状態である。

20

【 0 0 3 2 】

また、有機 E L 素子の発光色を色ごとに適切化する場合についても上記と同様のことが言える。なお、発光色の適切化は、例えば、各発光色の色純度を向上させることで行われる。

【 0 0 3 3 】

上記第 1 コンタクトホールの容積を第 1 窪み部の容積と、第 2 コンタクトホールの容積を第 2 窪み部の容積と読み替えてもよい。

30

ここで、「前記層間絶縁膜の厚みを、前記第 1 電極板群が形成された箇所が、前記第 2 電極板群が形成された箇所より厚く形成する」ために、第 1 電極板群が形成された箇所と、第 2 電極板群が形成された箇所とにおいて、層間絶縁膜の上面と下面との少なくとも一方の高さを変えることができる。

【 0 0 3 4 】

層間絶縁膜の上面の高さを変えるために、例えば、層間絶縁膜の上面に段差を形成し、第 1 電極板群が形成された箇所が、第 2 電極板群が形成された箇所よりも高くなるようにすることができる。

【 0 0 3 5 】

層間絶縁膜の下面の高さを変えるために、例えば、T F T 層における第 1 電極板群に対応する箇所が、第 2 電極板群に対応する箇所よりも低くなるようにすることができる。

40

なお、本態様は、例えば、第 1 電極板群に対応する箇所が、第 2 電極板群に対応する箇所よりも低い基板を具備し、その基板上に T F T 層が形成されたものとするることができる。

【 0 0 3 6 】

ここで、「第 1 色用の電極板上の領域に対応する第 1 有機機能層の体積が、各第 2 色用の電極板上の領域に対応する第 2 有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内」というのは、第 1 有機機能層の体積と第 2 有機機能層の体積が実質的に同一（誤差範囲内）であること、数値的には第 1 有機機能層の体積と第 2 有機機能層の体積の差が、第 1 有機機能層の体積に対して 10 % 以内であることを意味するものとする。

50

【0037】

本態様において、第1窪み部の容積と第2窪み部の容積との差を、インク一滴の体積よりも大きくしてもよい（例えば、1.5滴分）。

なお、第1有機機能層の体積と第2有機機能層の体積との差は、第1窪み部に堆積した第1有機機能層の体積から第2窪み部に堆積した第2有機機能層の体積を差し引いた体積未満であることが望ましい。

【0038】

ここで、「第1窪み部以外の第1色用の電極板上の領域」とは、例えば、平面視において、第1色用の電極板上の領域のうち、第1窪み部が形成された領域（第1窪み部の周囲の領域を含む場合がある）を除いた平坦な領域をいう。具体的には、例えば、平面視において発光領域に位置する部分である。第2色用の電極板上の領域についても同様である。

10

【0039】

本態様において、上方とは、有機機能層等の積層方向の上方を意味しており、TFT層から遠ざかる方向となる。

なお、電極板上に有機機能層以外の層（例えば、画素規制層）が形成されていても、有機機能層以外の層が窪み部に凹入して窪んでいれば、有機機能層の膜厚差を微調節することができる。

【0040】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルは、前記第1色用の電極板に対応する第1コンタクトホールの上面積と前記第2色用の電極板に対応する第2コンタクトホールの上面積とは、同一又は同一の近傍値の範囲内である、という構成を採用することができる。

20

【0041】

本態様によれば、第1コンタクトホールの上面積と第2コンタクトホールの上面積とを同一又は同一の近傍値の範囲内とした場合であっても、第1コンタクトホールと第2コンタクトホールとの深さを変えることで、第1コンタクトホールの容積を第2コンタクトホールの容積よりも大きくすることができる。その結果、第1有機機能層の膜厚と第2有機機能層の膜厚との差を微調節することができる。

【0042】

また、第1及び第2コンタクトホールの上面積を実質同一にすることにより、第1及び第2窪み部の開口面積も実質同一となり、塗布されたインクの窪み部内への入り込みやすさを概ね等しくすることができる。

30

【0043】

なお、上面積とは、例えば、層間絶縁膜の上面に開口したコンタクトホールの開口面積とすることや、コンタクトホールの上部を有機機能層等の積層方向と垂直な断面によって切断した場合における開口の面積とすることができる。コンタクトホールの上部とは、例えば、コンタクトホールの周縁部の最上部とコンタクトホールの深さ寸法の15%下降した位置との間のいずれかの部分とすることができる。

【0044】

また、「同一又は同一の近傍値の範囲内」とは、第1コンタクトホールの上面積と第2コンタクトホールの上面積とが実質的に同一（誤差範囲内）であること、数値的には第1コンタクトホールの上面積と第2コンタクトホールの上面積との差が、第1コンタクトホールの上面積に対して10%以内であることを意味するものとする。

40

【0045】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記コンタクトホールの上面積は、前記層間絶縁膜の前記コンタクトホールにおける周縁部のもっとも高い位置から10%、又は10%の近傍値の範囲内に下がった位置における前記コンタクトホールの直径で規定される円の面積である、という構成を採用することができる。

【0046】

本態様は、コンタクトホールの平面形状が円形とされており、コンタクトホールの周縁

50

部の最も高い位置からコンタクトホールの深さの10%前後下降した位置におけるコンタクトホールの直径によって上面積を規定するものである。これにより、コンタクトホールの周縁部の最も高い位置およびその付近において、形状や高さのばらつきが存在する場合でも、その影響を低減することができる。なお、10%の近傍値の範囲内は、誤差範囲内であり、例えば、9%以上で11%以下の範囲内の値とすることができる。

【0047】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記第1コンタクトホールに対応する前記第1窪み部は、第1画素規制層により覆われ、前記第1画素規制層の上方に第1有機機能層が形成され、前記第2コンタクトホールに対応する前記第2窪み部は、第2画素規制層により覆われ、前記第2画素規制層の上方に第2有機機能層が形成されている、という構成を採用することができる。

10

【0048】

本態様によれば、絶縁性を有する画素規制層によって窪み部を覆うことで、窪み部と有機機能層とを電氣的に絶縁することができる。これにより、例えば、窪み部の開口縁上方において、有機発光層が、局所的な電流の集中によって窪み部の周囲と異なる輝度で発光することを防止することができる。

【0049】

第1画素規制層及び第2画素規制層の各々は、例えば、SiO₂（酸化ケイ素）膜、あるいはSiN（窒化ケイ素）膜、SiON（酸素窒化ケイ素）膜などの酸化物（窒化物を含む）で形成される。前記SiO膜、あるいはSiN膜などの酸化物は、第1有機機能層及び第2有機機能層の各々とのぬれ性が良好であるため、上記画素規制層上に有機機能層を含むインクが直接塗布される場合には、第1有機機能層の第1窪み部への入り込み及び第2有機機能層の第2窪み部への入り込みが良好となる。

20

【0050】

従って、異なる色に対応する有機機能層の膜厚差を微調節するためにより好適である。

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルは、前記第1有機機能層は、インクジェット式塗布方法により所定の体積の液滴が塗布されることにより、前記第1電極板群の上方に連続して形成され、前記第2有機機能層は、インクジェット式塗布方法により前記所定の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内の体積の液滴が塗布されることにより前記第2電極板群の上方に連続して形成され、前記第1色用の電極板上の領域に対応する前記第1有機機能層の体積は、前記第2色用の電極板上の領域に対応する前記第2有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内である、という構成を採用することができる。

30

【0051】

本態様は、有機機能層の形成において、インクジェット式塗布方法によって滴下される液滴の体積が、第1有機機能層の形成と第2有機機能層の形成とで実質同一（例えば、体積差が10%以内の誤差範囲内）にされている。また、第1有機機能層の体積は第2有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内（例えば、体積差が10%以内の誤差範囲内）であり、各電極板上の領域に滴下される液滴数は同一にされている。

【0052】

ここで、前述のように、第1コンタクトホールの容積が第2コンタクトホールの容積よりも大きくされているため、第1色用の電極板の第1窪み部以外の部分に対応する第1有機機能層の膜厚を、第2色用の電極板の第2窪み部以外の部分に対応する第2有機機能層よりも薄くすることができる。

40

【0053】

このように、本態様によると、インクジェット式塗布方法において、色ごとの塗布条件を同じにすることにより、製造装置あるいは製造プロセスを簡易化するとともに、第1コンタクトホールの容積を第2コンタクトホールよりも大きくすることで、第1有機機能層の膜厚を第2有機機能層よりも薄くすることができる。すなわち、異なる色に対応する有機機能層の膜厚差を微調節することができる。

【0054】

50

従来、インクジェット式塗布方法で有機EL発光素子の有機機能層を形成する場合は、インクジェット装置のショット数（例えば、サブピクセルあたりのインクの滴下数）をRGB等の色ごとに調節して各有機機能層の膜厚を調節していたため、有機機能層の膜厚の微調節が困難であった。例えば、第1色用の電極板に対応する領域に、有機機能層を構成する有機インクの液滴の10滴を滴下する場合は、ショット数を11滴に変更すると、膜厚は約1.1倍（約10%増）となる。すなわち、この場合には、インクジェット装置では約10%以下での膜厚制御は行なうことができない。従って、異なる色に対応する有機機能層の膜厚差を微調節することができない。

【0055】

また、前記有機機能層が中間層である場合は、RGBなどの各色で同じ材料を用いて印刷する。この際に、異なる色に対応する有機機能層の膜厚差を調節するためには、インクジェット装置のRGBそれぞれのノズルに対してショット数制御が必要となり、装置が複雑になる。

10

【0056】

それに対し、本態様では、第1有機機能層の体積と、第2有機機能層の体積とが実質同一である。そして、コンタクトホール容積差を、例えばインクの1.5滴分等とすることができ、各色のショット数が同じであっても有機機能層の膜厚差を微調節することができる。すなわち、本態様ではRGB各色において有機機能層の膜を形成する際のインクジェット装置による滴下量は同じであっても、膜厚を各発光色に対応して任意に微調節ができるようになる。

20

【0057】

また、各発光色に対応したインクジェット装置の全ノズルからの液滴の滴下が、同じ条件で塗布することができるので、インクジェット装置の各発光色に対応した各ノズルの制御の必要が無く、装置の制御を簡易化することができる。

【0058】

この結果、前記第1色用の電極板上の領域に対応する前記第1有機機能層の体積は、前記第2色用の電極板上の領域に対応する前記第2有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内としつつ、前記窪み部の体積の調節により、前記有機機能層の膜厚を微調節することができるようになる。

30

【0059】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記第1有機機能層の膜厚と前記第2有機機能層の膜厚との差は、前記インクジェット式塗布方法により前記所定の体積の液滴が塗布される場合、前記第1色用の電極板ごとに塗布される前記液滴数が、 n 滴増加することにより形成される前記第1有機機能層の膜厚より大きく、前記液滴数が $n+1$ 滴増加することにより形成される前記第1有機機能層の膜厚より小さい、という構成を採用することができる。

【0060】

本態様では、第1色用の電極板の第1窪み部以外の部分に対応する第1有機機能層の膜厚と、第2色用の電極板の第2窪み部以外の部分に対応する第2有機機能層の膜厚との差を、インクジェット装置のノズルから滴下される液滴の最小単位である1つの液滴で形成される膜厚よりも小さく微調節することができる（例えば、液滴の半分の膜厚）。なお、 n は0以上の整数（ $n \geq 0$ ）である。

40

【0061】

なお、「液滴数が n 滴増加することにより形成される第1有機機能層の膜厚」は、 n 滴の液滴による第1有機機能層の膜厚の増加分とすることができる。また、「液滴数が $n+1$ 滴増加することにより形成される前記第1有機機能層の膜厚」は、 $n+1$ 滴の液滴による第1有機機能層の膜厚の増加分とすることができる。

【0062】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記第1色は青色である、という構成を採用することができる。

50

有機EL発光素子において、例えば、電極板側で反射して対向電極側に出射する光の光路長を各色の光の波長に適したものにして、発光層から対向電極側に直接出射する光と強めあうように干渉させるキャビティ構造が採用されている場合がある。このキャビティ構造の一部を有機機能層が構成している場合には、青色に対応する有機機能層の膜厚を薄くすることが好ましい。それは、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の発光色の中で青色の光の波長が、赤色、緑色の光の波長より短いため、光路長を短くすることが好ましいからである。

【0063】

本態様は、前記第1色を青色としている。そのため、他の色の発光色の前記有機機能層の膜厚より、前記青色の前記有機機能層の膜厚を薄くすることとなる。従って、例えば、光取出し効率が優れた多数色の有機EL発光素子を実現できる。

10

【0064】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記層間絶縁膜の上面は、前記第1電極板群が形成された箇所が、前記第2電極板群が形成された箇所より高く形成されており、前記TFT層は、前記第1コンタクトホールとの底面に対応する箇所と、前記第2コンタクトホールの底面に対応する箇所とが同一又は同一の近傍値の範囲内の高さに形成されている、という構成を採用することができる。

【0065】

本態様では、層間絶縁膜の上面が段差を有する形状にされている。つまり、高低差が設けられている。その結果、TFT層において第1及び第2コンタクトホールに対応する部分の高さが同一又は同一の近傍値の範囲内(実質同一)であっても、コンタクトホールの深さを異ならせることができる。よって、容易にコンタクトホールの容積差を微調節することができる。

20

【0066】

ここで、TFT層には、TFTから電極板に電力を供給するための電極(実施形態におけるSD電極)が形成されており、その電極上にコンタクトホールが形成されている。そして、電極板の一部はコンタクトホールに凹入して窪み部となり、その窪み部の底壁部分が上記電極の上面と面接触することで、電極板と電極とが導通している。この場合、TFT層における第1(第2)コンタクトホールの底面に対応する箇所の高さは、上記電力供給用の電極の上面の高さとすることができる。

30

【0067】

なお、コンタクトホールの底面に対応する箇所が互いに同一又は同一の近傍値の範囲内の高さに形成されているとは、高さが実質同一であればよく、例えば、高さの差が、第1コンタクトホールの深さと第2コンタクトホールの深さととの差の5%以内とすることができる。

【0068】

ここで、一般的に、TFT層の第1及び第2コンタクトホールの底面に対応する箇所の高さは、実質同一にされているため、本態様は、一般的なTFT層に対応することができ、汎用性に富んでいる。

【0069】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記層間絶縁膜の上面は、前記第1電極板群が形成された箇所と、前記第2電極板群が形成された箇所とが同一又は同一の近傍値の範囲内の高さに形成されており、前記TFT層は、前記第1コンタクトホールの底面に対応する箇所が、前記第2コンタクトホールの底面に対応する箇所よりも低く形成されている、という構成を採用することができる。

40

【0070】

本態様では、層間絶縁膜の上面において、第1電極板群が形成された箇所と、第2電極板群が形成された箇所との間に高低差はなく、TFT層に高低差が設けられている。その結果、層間絶縁膜の上面において、第1電極板群が形成された箇所の高さが、第2電極板群が形成された箇所の高さと実質同一であっても、コンタクトホールの深さを異ならせる

50

ことができる。よって、容易にコンタクトホールの容積差を微調節することができる。

【0071】

ここで、層間絶縁膜の上面において、第1電極板群が形成された箇所の高さが、第2電極板群が形成された箇所の高さと同一とは、実質同一であればよい。実質同一については、例えば、前項と同様に、第1コンタクトホールの深さと第2コンタクトホールの深さとの差の5%以内とすることができる。

【0072】

ここで、本態様では、層間絶縁膜の上面において、第1電極板群が形成された箇所と、第2電極板群が形成された箇所との間に高低差がないため、層間絶縁膜上に有機EL素子を形成し易いという利点がある。

【0073】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記第2電極板群と隣接して形成され、ライン状に配列された複数の第3色用の電極板を含む第3電極板群と、前記第3電極板群の前記第2電極板群と反対側の長辺部分に沿って形成された第4隔壁と、前記第3隔壁と前記第4隔壁との間において前記第3電極板群の上方に形成された第3有機機能層と、を含み、前記対向電極は、前記第3有機機能層の上方に設けられ、前記層間絶縁膜には、前記第3色用の電極板の各々とTFT層とを接続する第3コンタクトホールが設けられ、前記第3色用の電極板は、前記第3コンタクトホールの形状に沿って窪む第3窪み部を有しており、前記層間絶縁膜は、前記第1電極板群が形成された箇所が、前記第3電極板群が形成された箇所より厚く形成されており、前記第1コンタクトホールは、前記第3コンタクトホールより深く、かつ、容積が大きく、前記第1色用の電極板上の領域に対応する前記第1有機機能層の体積は、前記第3色用の電極板上の領域に対応する前記第3有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、前記第1有機機能層の膜厚は、前記第1コンタクトホールに対応する第1窪み部に入り込む前記第1有機機能層の量が前記第3コンタクトホールに対応する第3窪み部に入り込む前記第3有機機能層の量より多いことにより、前記第1窪み部以外の前記第1色用の電極板上の領域において、前記第3窪み部以外の前記第3色用の電極板上の領域に形成された前記第3有機機能層の膜厚より薄い、という構成を採用することができる。

【0074】

本態様では、前記第1電極板群と前記第2電極板群に対応した有機EL発光素子に加えて、第3電極板群に対応した有機EL発光素子が存在する。即ち3色の発光色によって画像を表示する有機EL表示パネルが実現できる。そして、前記3色を赤、緑、青(RGB)とすることで、汎用性の高い有機EL表示パネルを実現することができる。

【0075】

本態様において、第3コンタクトホールの容積を、第2コンタクトホールの容積と異ならせた場合には、コンタクトホールの体積をRGB毎に異ならせることができる。RGBの各サブピクセルでは、通常、放射される光の取出し効率を向上させるために前述のキャビティ構造が採用される。この場合、RGBの各色の光の波長に対応した最適な光路長となるように有機機能層の膜厚差を微調節できることが好ましい。

【0076】

本態様によれば、コンタクトホールの容積差は、層間絶縁膜の膜厚及びコンタクトホールの形状(上面積の大きさ等)によって、比較的微調節がしやすいものである。その結果、有機機能層の膜厚差の微調節が実現できる。

【0077】

したがって、インクジェット式塗布方法で有機機能層を形成する場合において、各サブピクセルのキャビティを適切化するための前記有機機能層の膜厚差を、RGBの各色に対応して形成されたコンタクトホールの体積を変えることで微調節できる。

【0078】

特に、RGBの各色の発光波長に対応してキャビティを適切化するために、例えば、コンタクトホールの体積を、B、G、Rの順に小さくすることができる(B>G>R)。こ

10

20

30

40

50

のことによって、有機機能層の膜厚を、B、G、Rの順に厚くすることができる（ $B < G < R$ ）。なお、キャピティには有機機能層以外の層が含まれているので、有機機能層以外の層の膜厚によっては、RGBの各色に対応する有機機能層の膜厚の厚さを上記順序と異ならせてもよい。

【0079】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記第1色用の電極板に対応する第1コンタクトホールの上面積、前記第2色用の電極板に対応する第2コンタクトホールの上面積及び前記第3色用の電極板に対応する第3コンタクトホールの上面積とは、同一又は同一の近傍値の範囲内である、という構成を採用することができる。

【0080】

本態様によれば、各色に対応するコンタクトホールの上面積を実質同一にした場合であっても、コンタクトホールの形状によって、前記有機機能層の膜厚を微調節できる。

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記コンタクトホールの上面積は、前記層間絶縁膜における前記コンタクトホールの周縁部のもっとも高い位置から10%又は10%の近傍値の範囲内に下がった位置における前記コンタクトホールの直径で規定される円の面積である、という構成を採用することができる。

【0081】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記層間絶縁膜の上面は、前記第1電極板群が形成された箇所が、前記第2電極板群が形成された箇所及び前記第3電極板群が形成された箇所より高く形成されており、前記TF T層は、前記第1コンタクトホール

【0082】

の底面に対応する箇所、前記第2コンタクトホールの底面に対応する箇所、及び前記第3コンタクトホールの底面に対応する箇所が同一又は同一の近傍値の範囲内の高さに形成されている、という構成を採用することができる。

【0083】

本態様では、層間絶縁膜の上面が段差を有する形状にされている。つまり、高低差が設けられている。その結果、TF T層において第1、第2及び第3コンタクトホールの底面に対応する部分の高さが実質同一であっても、コンタクトホールの深さを異ならせることができる。よって、容易にコンタクトホールの容積差を微調節することができる。

【0084】

ここで、一般的に、TF T層の第1、第2及び第3コンタクトホールの底面に対応する箇所の高さは、実質同一にされているため、本態様は、一般的なTF T層を用いることができ、汎用性に富んでいる。

【0085】

なお、コンタクトホールの底面に対応する箇所が互いに同一又は同一の近傍の範囲内の高さに形成されているとは、前記コンタクトホールの底面が形成されている高さが実質同一であればよい。例えば、前記高さの差は、第1コンタクトホールの深さと、第2コンタクトホール及び第3コンタクトホールのうちの浅い方の深さとの差の5%以内とすることができる。

【0086】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記層間絶縁膜の上面は、前記第1電極板群が形成された箇所、前記第2電極板群が形成された箇所、及び前記第3電極板群が形成された箇所が同一又は同一の近傍値の範囲内の高さに形成されており、前記TF T層は、前記第1コンタクトホールの底面に対応する箇所が、前記第2コンタクトホールの底面に対応する箇所及び前記第3コンタクトホールの底面に対応する箇所よりも低く形成されている、という構成を採用することができる。

本態様では、TF T層に高低差が設けられている。その結果、層間絶縁膜の上面において、第1電極板群が形成された箇所の高さが、第2電極板群及び第3電極板群が形成された箇所の高さを実質同一であっても、コンタクトホールの深さを異ならせることができる。よって、容易にコンタクトホールの容積差を微調節することができる。

10

20

30

40

50

【0087】

ここで、本態様では、層間絶縁膜の上面において、第1電極板群が形成された箇所と、第2電極板群及び第3電極板群が形成された箇所との間に高低差がないため、層間絶縁膜上に有機EL素子を形成し易いという利点がある。

【0088】

なお、第1、第2、及び第3電極板群が形成された箇所の高さが、実質同一であるとは、前項と同様に、例えば、前記コンタクトホール底面の形成されている高さの差は、第1コンタクトホールの深さと、第2コンタクトホール及び第3コンタクトホールのうちの浅い方の深さととの差の5%以内とすることができる。

【0089】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記第1有機機能層及び前記第2有機機能層は、電荷注入層、あるいは電荷輸送層のいずれかであり、前記第1有機機能層と前記対向電極との間に第1有機発光層が形成され、前記第2有機機能層と前記対向電極との間に第2有機発光層が形成されている、という構成を採用することができる。

【0090】

電荷注入層、電荷輸送層等の膜厚は、有機発光層よりも薄く形成される場合が多いため、膜厚差を微調節することが難しい。よって、コンタクトホールの容積差によって膜厚差を微調節できるメリットが大きい。

【0091】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記第1有機機能層、前記第2有機機能層、及び前記第3有機機能層は、電荷注入層あるいは電荷輸送層のいずれかであり、前記第1有機機能層と前記対向電極との間に第1有機発光層が形成され、前記第2有機機能層と前記対向電極との間に第2有機発光層が形成され、前記第3有機機能層と前記対向電極との間に第3有機発光層が形成されている、という構成を採用することができる。

【0092】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記第1有機機能層及び前記第2有機機能層は、有機発光層である、という構成を採用することができる。

本態様によれば、第1コンタクトホールの容積を、第2コンタクトホールの容積よりも大きくすることで、各色に対応する有機発光層の膜厚の差を微調節することができる。その結果、有機発光層の色度や輝度をより適切にすることができる。あるいは、光の取出し効率を向上させることができる。

【0093】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記第1有機機能層、前記第2有機機能層、及び前記第3有機機能層は、有機発光層である、という構成を採用することができる。

【0094】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記電極板は陽極であり、前記対向電極は陰極である、という構成を採用することができる。

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記電極板は陰極であり、前記対向電極は陽極である、という構成を採用することができる。

【0095】

さらに、本発明の一態様における表示装置は、上記いずれかの態様に記載の有機EL表示パネルを備えている。

本態様によれば、上記いずれかの態様に記載の有機EL表示パネルを備えた表示装置を実現できる。

【0096】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルの製造方法は、基板を準備する第1工程と、前記基板上にTFE層を形成する第2工程と、前記TFE層上に層間絶縁膜を形成する第3工程と、複数の第1色用の電極板をライン状に配列した第1電極板群を前記

10

20

30

40

50

層間絶縁膜上に形成し、前記第1電極板群と隣接して複数の第2色用の電極板をライン状に配列した第2電極板群を前記層間絶縁膜上に形成する第4工程と、前記第1電極板群の一方の長辺部分に沿って第1隔壁を形成し、前記第1電極板群の他方の長辺部分と前記第2電極板群の一方の長辺部分との間に第2隔壁を形成し、前記第2電極板群の他方の長辺部分に沿って第3隔壁を形成する第5工程と、前記第1隔壁と前記第2隔壁との間において前記第1電極板群の上方に連続して第1有機機能層を形成する第6工程と、前記第2隔壁と前記第3隔壁との間において前記第2電極板群の上方に連続して第2有機機能層を形成する第7工程と、前記第1有機機能層及び前記第2有機機能層の上方に対向電極を設ける第8工程と、を具備し、前記第3工程において、前記層間絶縁膜の厚みは、前記第1電極板群が形成された箇所が、前記第2電極板群が形成された箇所より厚く形成されており、前記層間絶縁膜には、前記第1色用の電極板の各々とTFT層とを接続する第1コンタクトホール、及び、前記第2色用の電極板の各々とTFT層とを接続する第2コンタクトホールが設けられ、前記第1コンタクトホールは、前記第2コンタクトホールより深く、かつ、容積が大きく形成され、前記第4工程において、前記第1色用の電極板の各々には、前記第1コンタクトホールの形状に沿って第1窪み部が形成され、前記第2色用の電極板の各々には、前記第2コンタクトホールの形状に沿って第2窪み部が形成され、前記第6工程で形成された前記第1有機機能層及び前記第7工程で形成された前記第2有機機能層において、前記第1色用の電極板上の領域に対応する前記第1有機機能層の体積は、前記第2色用の電極板上の領域に対応する前記第2有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、前記第1有機機能層の膜厚は、前記第1コンタクトホールに対応する第1窪み部に入り込む前記第1有機機能層の量が前記第2コンタクトホールに対応する第2窪み部に入り込む前記第2有機機能層の量より多いことにより、前記第1窪み部以外の前記第1色用の電極板上の領域において、前記第2窪み部以外の前記第2色用の電極板上の領域に形成された前記第2有機機能層の膜厚より薄い、という構成が採用されている。

【0097】

本態様によれば、前述の本発明の一態様における有機EL表示パネルを製造することができる。よって、例えば、層間絶縁膜の厚みを異ならせることで第1コンタクトホールの容積と第2コンタクトホールの容積との差を微調節し、第1有機機能層の膜厚と、第2有機機能層の膜厚との差を容易に微調節することができる。その結果、例えば、有機EL素子内での光の共振条件を色ごとに適切化でき、発光効率の優れた表示パネルを容易に得ることができる。

【0098】

ここで、「前記層間絶縁膜を、前記第1電極板群が形成された箇所が、前記第2電極板群が形成された箇所より厚く形成する」ために、第1電極板群が形成された箇所と、第2電極板群が形成された箇所とにおいて、層間絶縁膜の上面と下面との少なくとも一方の高さを変えることができる。

【0099】

層間絶縁膜の上面の高さを変えるために、例えば、第3工程において、フォトリソグラフィ法等により、層間絶縁膜の上面に段差を形成し、第1電極板群が形成された箇所を、第2電極板群が形成された箇所よりも高くすることができる。

【0100】

層間絶縁膜の下面の高さを変えるために、例えば、第1工程と第2工程との間に、基板上に段差を形成し、TFT層における第1電極板群に対応する箇所を、第2電極板群に対応する箇所よりも低くする工程を設けることができる。なお、基板上に段差を形成するために、例えば、基板上に高低差のある絶縁層等を形成してもよいし、基板をエッチング等によって削ることで基板自体に高低差を形成してもよい。さらに、第1工程において、上面に段差が形成された基板を準備してもよい。

【0101】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルの製造方法に、前記第1色用の電極板に対応するコンタクトホールの上面積と前記第2色用の電極板に対応するコンタクト

10

20

30

40

50

ホールの上面積とは、同一又は同一の近傍値の範囲内である、という構成を採用することができる。

【0102】

本態様によれば、第1コンタクトホールの上面積と第2コンタクトホールの上面積とを同一又は同一の近傍値の範囲内とした場合であっても、第1コンタクトホールと第2コンタクトホールとの深さを変えることで、第1コンタクトホールの容積を第2コンタクトホールの容積よりも大きくすることができる。その結果、第1有機機能層の膜厚と第2有機機能層の膜厚との差を微調節することができる。

【0103】

また、第1及び第2コンタクトホールの上面積を実質同一にすることにより、第1及び第2窪み部の開口面積も略同一となり、有機機能層を含むインクを窪み部内への入り込みやすさを概ね等しくすることができる。

【0104】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルの製造方法に、前記第4工程と前記第5工程との間に、前記第1コンタクトホールに対応する前記第1窪み部を覆うように第1画素規制層を形成し、前記第2コンタクトホールに対応する前記第2窪み部を覆うように第2画素規制層を形成する工程を設け、前記第6工程において、前記第1画素規制層の上方に前記第1有機機能層が形成され、前記第7工程において、前記第2画素規制層の上方に前記第2有機機能層が形成される、という構成を採用することができる。

【0105】

本態様によれば、絶縁性を有する画素規制層によって窪み部を覆うことで、窪み部と有機機能層とを電氣的に絶縁することができる。これにより、例えば、窪み部の開口縁上方において、発光層が、局所的な電流の集中によって窪み部の周囲と異なる輝度で発光することを防止することができる。

【0106】

また、第1画素規制層及び第2画素規制層の各々が、例えば、SiO₂膜、あるいはSiN膜などの酸化物(窒化物を含む)で形成され、かつ、上記画素規制層上に有機機能層を含むインクが直接塗布される場合には、第1有機機能層の第1窪み部への入り込み及び第2有機機能層の第2窪み部への入り込みが良好となる。

【0107】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルの製造方法に、前記第6工程において、前記第1有機機能層は、インクジェット式塗布方法により所定の体積の液滴を塗布することにより、前記第1電極板群の上方に連続して形成し、前記第7工程において、前記第2有機機能層は、インクジェット式塗布方法により前記所定の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内の体積の液滴を塗布することにより、前記第2電極板群の上方に連続して形成される、という構成を採用することができる。

【0108】

本態様によると、インクジェット式塗布方法において、色ごとの塗布条件を同じにすることにより、製造装置あるいは製造プロセスを簡易化するとともに、第1コンタクトホールの容積を第2コンタクトホールよりも大きくすることで、第1有機機能層の膜厚を第2有機機能層よりも薄くすることができる。すなわち、異なる色に対応する有機機能層の膜厚差を微調節することができる。

【0109】

前記第1有機機能層の膜厚と前記第2有機機能層の膜厚との差は、前記インクジェット式塗布方法により前記所定の体積の液滴が塗布される場合、前記第1色用の電極板ごとに塗布される液滴数が、 n 滴増加することによる前記第1有機機能層の膜厚の増加分より大きく、前記液滴数が $n+1$ 滴増加することによる前記第1有機機能層の膜厚の増加分より小さい、という構成を採用することができる。

【0110】

本態様によれば、第1有機機能層の膜厚と第2有機機能層の膜厚との差を、インクジェ

10

20

30

40

50

ット装置のノズルから滴下される液滴の最小単位である1つの液滴で形成される膜厚よりも小さく微調節することができる。なお、上記第1有機機能層の膜厚は、第1有機機能層のうちの第1色用の電極板の第1窪み部以外に対応する部分の膜厚である。第2有機機能層の膜厚についても同様である。

【0111】

さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルの製造方法は、基板を準備する第1工程と、前記基板上にTF T層を形成する第2工程と、前記TF T層上に層間絶縁膜を形成する第3工程と、複数の第1色用の電極板をライン状に配列した第1電極板群を前記層間絶縁膜上に形成し、前記第1電極板群と隣接して複数の第2色用の電極板をライン状に配列した第2電極板群を前記層間絶縁膜上に形成し、前記第2電極板群と隣接して複数の第3色用の電極板をライン状に配列した第3電極板群を前記層間絶縁膜上に形成する第4工程と、前記第1電極板群の一方の長辺部分に沿って第1隔壁を形成し、前記第1電極板群の他方の長辺部分と前記第2電極板群の一方の長辺部分との間に第2隔壁を形成し、前記第2電極板群の他方の長辺部分と前記第3電極板群の一方の長辺部分との間に第3隔壁を形成し、前記第3電極板群の他方の長辺部分に沿って第4隔壁を形成する第5工程と、前記第1隔壁と前記第2隔壁との間において前記第1電極板群の上方に連続して第1有機機能層を形成する第6工程と、前記第2隔壁と前記第3隔壁との間において前記第2電極板群の上方に連続して第2有機機能層を形成する第7工程と、前記第3隔壁と前記第4隔壁との間において前記第3電極板群の上方に連続して第3有機機能層を形成する第8工程と、前記第1有機機能層及び前記第2有機機能層の上方に対向電極を設ける第9工程と、を具備し、前記第3工程において、前記層間絶縁膜の厚みは、前記第1電極板群が形成された箇所が、前記第2電極板群が形成された箇所及び前記第3電極板群が形成された箇所より厚く形成されており、前記層間絶縁膜には、前記第1色用の電極板の各々とTF T層とを接続する第1コンタクトホール、前記第2色用の電極板の各々とTF T層とを接続する第2コンタクトホール、及び、前記第3色用の電極板の各々とTF T層とを接続する第3コンタクトホールが設けられ、前記第1コンタクトホールの深さは、前記第2コンタクトホール及び前記第3コンタクトホールより深く、かつ、容積が大きく形成され、前記第4工程において、前記第1色用の電極板の各々には、前記第1コンタクトホールの形状に沿って第1窪み部が形成され、前記第2色用の電極板の各々には、前記第2コンタクトホールの形状に沿って第2窪み部が形成され、前記第3色用の電極板の各々には、前記第3コンタクトホールの形状に沿って第3窪み部が形成され、前記第6工程、前記第7工程及び前記第8工程でそれぞれ形成された前記第1有機機能層、前記第2有機機能層及び前記第3有機機能層において、前記第1色用の電極板上の領域に対応する前記第1有機機能層の体積は、前記第2色用の電極板上の領域に対応する前記第2有機機能層の体積及び前記第3色用の電極板上の領域に対応する前記第3有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、前記第1有機機能層の膜厚は、前記第1コンタクトホールに対応する第1窪み部に入り込む前記第1有機機能層の量が、前記第2コンタクトホールに対応する第2窪み部に入り込む前記第2有機機能層の量及び前記第3コンタクトホールに対応する第3窪み部に入り込む前記第3有機機能層の量より多いことにより、前記第1窪み部以外の前記第1色用の電極板上の領域において、前記第2窪み部以外の前記第2色用の電極板上の領域に形成された前記第2有機機能層の膜厚及び前記第3窪み部以外の前記第3色用の電極板上の領域に形成された前記第3有機機能層の膜厚より薄い、という構成を採用することができる。

【0112】

本態様によれば、前記第1の電極板群と前記第2の電極板群に対応した有機EL発光素子に加えて、第3の電極板群に対応した発光色、即ち3色の発光色を有する有機EL発光素子可以实现できる。そして、前記3色を赤、緑、青(RGB)とすることで、光取出効率が低い有機EL表示パネルを実現することができる。

【0113】

さらに、本発明の一態様に係る有機EL表示パネルでは、上記構成において、前記コン

10

20

30

40

50

タクトホールは、層間絶縁膜の上面側に開口する上側開口部と、下面側に開口する下側開口部とを有しており、前記電極板は、前記コンタクトホールに沿って窪む窪み部において、前記下側開口部を通じて前記TFT層と電氣的に接続されている、という構成を採用することができる。

【0114】

さらに、本発明の一態様に係る有機EL表示パネルでは、上記構成において、前記コンタクトホールは、前記上側開口部から前記下側開口部に近づくに従い連続的に縮径する形状の上段部分と、前記下側開口部から前記上側開口部に近づくに従い連続的に拡径する形状の下段部分とを有し、上段部分と下段部分との間に段差（あるいは段差面）が存在する、という構成を採用することができる。

10

【0115】

<実施の形態1>

（表示パネル100の構成）

図1は、実施の形態1に係る表示パネル100の要部構成を模式的に示す断面図である。図2は、表示パネル100の要部構成を示す斜視図である。

【0116】

表示パネル100は、有機材料の電界発光現象を利用した有機EL表示パネルである。表示パネル100では、画素（ピクセル）が縦方向及び横方向（X方向及びY方向）にマトリクス状に配列されており、各画素は、隣接するRGB（赤緑青）3色のサブピクセルによって構成されている。図2に示す有機EL素子20a、20b、20cはトップエミッション型の有機EL素子であって、有機EL素子20aは第1色（青色）のサブピクセル、有機EL素子20bは第2色（緑色）のサブピクセル、有機EL素子20cは第3色（赤色）のサブピクセルに対応する。

20

【0117】

ここで、平面視において、各有機EL素子20が形成された領域を「素子形成領域」と称し、素子形成領域のうち、発光に寄与する領域を「サブピクセル」と称する。

図2に示すように、青色の有機EL素子20a...が縦方向（Y方向）にライン状に配列され、それに隣接して、緑色の有機EL素子20b...が縦方向（Y方向）にライン状に配列され、さらに、それに隣接して、赤色の有機EL素子20c...が縦方向（Y方向）にライン状に配列されている。そして、横方向（X方向）に隣接する3つの有機EL素子20a、20b、20cで一画素が形成される。

30

【0118】

図1は、配列された有機EL素子20c...を縦方向（Y方向）に切断した断面を示している。表示パネル100は、基板1と、基板1の主面上に積層形成されたTFT層2（薄膜トランジスタ層）とからなるTFT基板を備えている。

【0119】

また、表示パネル100において、TFT基板上に、層間絶縁膜3、陽極板5、画素規制層6、ホール注入層7が順に積層されている。さらに、それらの上に、隔壁8、ホール輸送層9、有機発光層10（以下、単に発光層という）、陰極層11が形成されて、有機EL素子20a、20b、20cが形成されている。

40

【0120】

なお、図1において、Z軸方向の最上部に、切断面の奥側にある隔壁8の側面が白塗りで図示されている（図3等も同様である）。また、図2では、ホール輸送層9、発光層10、陰極層11は示していない。

【0121】

基板1は、表示パネル100のベース部分となる基板であって、無アルカリガラス、ソーダガラス、無蛍光ガラス、燐酸系ガラス、硼酸系ガラス、石英、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエチレン、ポリエステル、シリコン系樹脂、又はアルミナ等の絶縁性材料で形成されている。

【0122】

50

TFT層2は、パネル全体の各有機EL素子20a~20cをアクティブマトリクス方式で駆動するためのTFT(薄膜トランジスタ)及び配線などからなる。なお図1において、TFT層2を二点鎖線で模式的に示し、TFTのソース電極又はドレイン電極に接続されたSD電極22を代表的に図示している。

【0123】

層間絶縁膜3は、絶縁性に優れる有機材料、例えばポリイミド、ポリアミド、アクリル系樹脂材料からなり、基板1の上記TFT層2を全体的に被覆している。

この層間絶縁膜3には、各有機EL素子20a, 20b, 20cごとに、それぞれ厚み方向(Z方向)に掘り下げたコンタクトホール13a, 13b, 13cが形成されている(図1、図3参照)。コンタクトホール13は、層間絶縁膜3の上面側及び下面側の両側に開口した円形の孔である。各コンタクトホール13a, 13b, 13cを区別せずに、単にコンタクトホール13と記載する場合がある。なお、コンタクトホール13の断面形状(XY平面に平行な断面の形状)には、円形以外に、楕円形、矩形などの形状を採用してもよい。

【0124】

この層間絶縁膜3は、各色の有機EL素子20a, 20b, 20cに対応する箇所の上面高さが異なっている。そのため、各コンタクトホール13a, 13b, 13cの深さも互いに異なっている。

【0125】

なお、コンタクトホール13内には、その内部形状に追従して陽極板5、画素規制層6、及びホール注入層7が凹入して積層される結果、ホール注入層7に、コンタクトホール13と似た形状の窪み部15が形成される。図2では、コンタクトホール13が窪み部15の下に隠れているため、破線の引き出し線を用いてコンタクトホール13に符号を付している(図3(a)も同様である)。

【0126】

次に、図3(a)~(c)を参照しながら、上記表示パネル100の構成を詳細に説明する。図3(a)は表示パネル100の概略構成を示す平面図、図3(b)は図3(a)のA-A'線で切断した断面、図3(c)は図3(a)のB-B'線で切断した断面である。なお、図3においても、ホール輸送層9、発光層10、陰極層11は示していない。

【0127】

図3(b)、(c)に示すように、層間絶縁膜3は、横方向(X方向)において階段状に上面高さが変化させられている。具体的には、図2に示すように、層間絶縁膜3の上面において、最上段の第1面3a、中間高さの第2面3b、最下段の第3面3cが、横方向(X方向)に繰り返し並べられ、それら第1面3a、第2面3b、第3面3cの間が斜面によって連結されている。

【0128】

また、第1面3a、第2面3b、第3面3cは、それぞれ縦方向(Y方向)に細長く延びた帯状の平面形状をなし、上面高さが均一にされている。

図3(a)に示すように、コンタクトホール13は、有機EL素子20と同様に行列状に配列されている。そして、コンタクトホール13は、横方向(X方向)において近接して並べられ、縦方向(Y方向)において所定の離間距離で等ピッチに配列されている。

【0129】

図3(b)に示すように、各色に対応するコンタクトホール13a, 13b, 13cの上面積が実質同一とされている(上面積については後に詳述する)。その一方で、3つのコンタクトホール13a, 13b, 13cは、それぞれ、高さの異なる第1面3a、第2面3b、第3面3cに開口して設けられており、深さ及び容積が相異なっている。

【0130】

具体的には、コンタクトホール13aが最も深く、容積が最も大きくされている。一方、コンタクトホール13cが最も浅く、容積が最も小さくされている。そして、コンタクトホール13bは中間的な深さで、容積も中間の大きさにされている。

【0131】

つまり、青緑赤の各色に対応するコンタクトホール13a, 13b, 13cの容積(体積)は、青色に対応するコンタクトホール13aの容積が最も大きく設定され、赤色に対応するコンタクトホール13cの容積が最も小さく設定されている。そのため、青色の素子形成領域に形成される窪み部15aの容積が最も大きく、赤色の素子形成領域に形成される窪み部15cの容積が最も小さくなっている。

【0132】

ここで、各コンタクトホール13a, 13b, 13cの下側の開口は、SD電極22の上面によって覆われ、塞がれている。すなわち、SD電極22の上面が、前記「TFT層のコンタクトホールの底面に対応する箇所」に相当する。なお、SD電極22の上面が、それぞれ、前記「TFT基板の第1、第2及び第3コンタクトホールの各々の底面」を形成している、と考えることもできる。

10

【0133】

本実施の形態において、各コンタクトホール13a, 13b, 13cの各々に対応するSD電極22の上面の高さは、互いに実質同一とされている。具体的には、各コンタクトホール13a, 13b, 13cに対応するSD電極22の上面の高さの差が、第1コンタクトホール13aの深さと第3コンタクトホール13cの深さととの差の5%以内にされている。なお、各コンタクトホールの深さは、後に例示する深さP1ないしP3のごとく決定される(図9)。

【0134】

陽極板5(5a~5c)は、電極板の一例であり、平面視矩形形状をなしている。陽極板5は、層間絶縁膜3上において、各有機EL素子20の素子形成領域(サブピクセル領域およびコンタクトホール13上の領域)に形成されている。各陽極板5は、サイズが等しくされ、縦方向(Y方向)及び横方向(X方向)において、他の陽極板5と所定距離離間した状態で行列状に配列されている。

20

【0135】

陽極板5には、図3(b), (c)に示すように、その一部がコンタクトホール13の内面に沿って凹入することで、コンタクトホール13と類似形状の窪み部23が形成されている。そして、陽極板5は、窪み部23の底壁部分において、TFT層2のSD電極22と電氣的に接続されている。

30

【0136】

この陽極板5を形成する材料は、光反射性であることが好ましく、例えば銀-パラジウム-銅の合金、Ag(銀)、銀-ルビジウム-金の合金、MoCr(モリブデンとクロムの合金)、NiCr(ニッケルとクロムの合金)、アルミニウム、アルミニウム合金等の金属材料が用いられる。また、ITO(Indium Tin Oxide)、IZO(In₂O₃-ZnO)、ZnO、InO、SnO等の半導体材料を用いてもよい。さらに、上記金属材料膜上に上記半導体材料膜を積層して陽極板5を形成してもよい。

【0137】

画素規制層6は、横方向(X方向)に延設された電気絶縁性の膜であって、陽極板5の縦方向(Y方向)における端部や、窪み部23を被覆している。

40

この画素規制層6が形成された箇所は、陽極板5と陰極層11との間の電氣的な導通が遮断され、有機EL素子20に駆動電圧が印加されても発光しないようにされている。すなわち、画素規制層6により、縦方向(Y方向)においてサブピクセル間の発光が規制されている。したがって、この画素規制層6により、縦方向(Y方向)に並ぶ複数のサブピクセルが区画されている。また、各画素規制層6は、縦方向(Y方向)において、複数のサブピクセルのサイズが均等になるように、等幅にされ、等ピッチで配されている。

【0138】

なお、画素規制層6によって、陽極板5の上記端部や窪み部23を被覆することにより、下記の輝度ムラの発生や、陽極板5と陰極層11との間のショートのを防止することができる。具体的には、陽極板5の上記端部や窪み部23の開口縁上方において発光層

50

10の膜厚が薄くなり、局所的に電流が集中すると、局所的に輝度が大きくなり輝度ムラが発生する。また、陽極板5の上記端部や窪み部23の開口縁上方において、発光層10やその他の層が途切れていると陽極板5と陰極層11との間でショートが発生する場合がある。

【0139】

画素規制層6は、シリコンオキサイド(SiO_2)、シリコンナイトライド(SiN)、シリコンオキシナイトライド(SiON)などによって形成された絶縁性無機膜である。その厚さは100nm~300nm程度である。

【0140】

ホール注入層7(7a~7c)は、陽極板5及び画素規制層6上にモリブデンやタンゲステン等の酸化物が積層されて形成されている。

また、ホール注入層7は、コンタクトホール13上の領域において、画素規制層6とともに陽極板5の窪み部23に凹入し、窪み部23と類似形状の窪み部15を形成している。なお、窪み部23の大きさ(直径や深さ寸法)に比して、画素規制層6やホール注入層7の膜厚が遥かに小さいため、ホール注入層7に形成された窪み部15の容積と、陽極板5に形成された窪み部23の容積とは、略同じである。

【0141】

隔壁8(8a~8c)は、絶縁性の有機材料(例えばアクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、ノボラック型フェノール樹脂等)からなり、少なくとも表面が撥液性を持つように形成されている。各隔壁8a, 8b, 8cは縦方向(Y方向)に長いライン状の形状をなしており、横方向(X方向)に連続して並ぶ有機EL素子20a, 20b, 20c同士の間を通過するように横方向(X方向)に等ピッチで形成されている。各隔壁8a, 8b, 8cの断面形状は台形であり、各隔壁幅(X方向の寸法)は均一である。

【0142】

ホール輸送層9(9a~9c)は、前記有機機能層の一例であり、隣接する隔壁8同士で挟まれた領域に、ホール注入層7を覆うように形成されている。そして、各ホール輸送層9は、画素規制層6上において上記窪み部15に部分的に入り込んでいる。ホール輸送層9は、縦方向(Y方向)に連続して形成されている。

【0143】

なお、後述するように、各色に対応するコンタクトホール13a, 13b, 13cの容積の違いに応じて窪み部15の容積が異なるため、発光領域等におけるホール輸送層9の膜厚が異なっている。

【0144】

ここで、隔壁8aと隔壁8bとの間には、青色に対応するホール輸送層9aが形成され、隔壁8bと隔壁8cとの間には、緑色に対応するホール輸送層9bが形成され、隔壁8cと隔壁8aとの間には、赤色に対応するホール輸送層9cが形成されている。

【0145】

また、発光層10(10a~10c)は、隣接する隔壁8同士で挟まれた領域において、ホール輸送層9の上に形成されている。そして、各発光層10は、各ホール輸送層9と共に上記窪み部15に部分的に入り込んでいる。

【0146】

ここで、ホール輸送層9aの上方に青色の光を発光する発光層10aが形成され、ホール輸送層9bの上方に緑色の光を発光する発光層10bが形成され、ホール輸送層9cの上方に赤色の光を発光する発光層10cが形成される。

【0147】

ホール輸送層9は、正孔移動度に優れる材料からなり、発光層10にホールを輸送する。ホール輸送層9を形成する材料の具体例としては、4,4'-ビス[N-(ナフチル)-N-フェニル-アミノ]ピフェニル(-NPBまたは-NPD)、N,N'-ビス(3-メチルフェニル)-(1,1'-ピフェニル)-4,4'-ジアミン(TPD)などのトリアリールアミン系化合物を挙げることができる。その他の例として、ピフェニル

10

20

30

40

50

誘導体、アントラセン誘導体、アニリン誘導体、チオフェン誘導体等がある。

【0148】

なお、陽極板5、ホール注入層7、ホール輸送層9は、3色の有機EL素子20a, 20b, 20cで共通の材料が用いられているが、発光層10は、3色の有機EL素子20a, 20b, 20cで別々に、青色, 緑色, 赤色の光を発する発光材料で形成されている。

【0149】

発光層10の材料としては、例えば、特開平5-163488号公報に記載のオキシノイド化合物、ペリレン化合物、クマリン化合物、アザクマリン化合物、オキサゾール化合物、オキサジアゾール化合物、ペリノン化合物、ピロロピロール化合物、ナフタレン化合物、アントラセン化合物、フルオレン化合物、フルオランテン化合物、テトラセン化合物、ピレン化合物、コロネン化合物、キノロン化合物及びアザキノロン化合物、ピラゾリン誘導体及びピラゾロン誘導体、ローダミン化合物、クリセン化合物、フェナントレン化合物、シクロペンタジエン化合物、スチルベン化合物、ジフェニルキノロン化合物、スチリル化合物、ブタジエン化合物、ジシアノメチレンピラン化合物、ジシアノメチレンチオピラン化合物、フルオレセイン化合物、ピリリウム化合物、チアピリリウム化合物、セレナピリリウム化合物、テルロピリリウム化合物、芳香族アルダジエン化合物、オリゴフェニレン化合物、チオキサnten化合物、アンスラセン化合物、シアニン化合物、アクリジン化合物、8-ヒドロキシキノリン化合物の金属錯体、2-ビピリジン化合物の金属錯体、シッフ塩とIII族金属との錯体、オキシ金属錯体、希土類錯体等の蛍光物質等を挙げることができる。

【0150】

陰極層11は、対向電極の一例であり、3色の有機EL素子20a, 20b, 20cの発光層10を一括して覆うように形成されている。陰極層11は、光透過性の材料、例えばITO、IZO(酸化インジウム亜鉛)等で形成される。

【0151】

なお、図示はしないが、陰極層11の上には、封止層が設けられる。この封止層は、例えばSiN(窒化シリコン)、SiON(酸窒化シリコン)等の光透過性の材料で形成される。

【0152】

このような表示パネル100において、上記のように隔壁8のピッチ及び隔壁幅は均等であり、画素規制層6のピッチ及び幅も均等なので、隔壁8及び画素規制層6で囲まれたサブピクセルのサイズは均等である。

【0153】

本実施の形態において、図3(a)に示すように、表示パネル100において、複数の青色用の陽極板5aが縦方向(Y方向)ライン状に配列されて第1陽極板群(第1電極板群の一例である)が形成されている。当該第1陽極板群に隣接して、複数の緑色用の陽極板5bが縦方向(Y方向)ライン状に配列されて第2陽極板群(第2電極板群の一例である)が形成されている。当該第2陽極板群に隣接して複数の赤色用の陽極板5cが縦方向(Y方向)ライン状に配列されて第3陽極板群(第3電極板群の一例である)が形成されている。

【0154】

ここで、図3(a)において、各陽極板群の全体的な形状は縦方向(Y方向)に細長い長方形をしており、各陽極板群は左右合わせて2つの長辺部分を有している。そして、第1陽極板群の一方(左側)の長辺部分に沿って第1隔壁(隔壁8a)が形成され、第1陽極板群の他方(右側)の長辺部分と第2陽極板群の一方(左側)の長辺部分との間に第2隔壁(隔壁8b)が形成され、第2陽極板群の他方(右側)の長辺部分と前記第3陽極板群の一方(左側)の長辺部分との間に第3隔壁(隔壁8c)が形成され、前記第3電極板群の他方(右側)の長辺部分に沿って第4隔壁(隔壁8a)が形成されている。なお、第4隔壁(隔壁8a)は、隣接する画素における第1隔壁(隔壁8a)となる。

10

20

30

40

50

【 0 1 5 5 】

(表示パネル 1 0 0 の製造方法)

まず、表示パネル 1 0 0 の製造方法の主要な部分について、図 4 を参照しながらその一例を説明する。

【 0 1 5 6 】

T F T 基板を作製(製作)する工程について説明する。

表示パネル 1 0 0 のサイズに応じた基板 1 を準備する。なお、表示パネル 1 0 0 の数倍の大きさの基板を準備し、複数の表示パネル 1 0 0 の製造を同時に進行してもよい。

【 0 1 5 7 】

T F T 層形成工程：

基板 1 上に、公知の製造方法(例えば、特開 2 0 0 3 - 2 4 1 6 8 3 号公報、特開 2 0 0 8 - 3 0 0 6 1 1 号公報等に記載)により、T F T 及び配線、S D 電極 2 2 からなる T F T 層 2 を形成する(図 4 (a))。例えば、スパッタリング法や C V D 法(化学気相成膜法)等によって、T F T、S D 電極 2 2、配線等が形成される。

10

【 0 1 5 8 】

T F T の形成において、ゲート電極、ゲート絶縁膜、ソース、ドレイン、チャンネル層等が形成される。S D 電極 2 2 は、ソース及びドレインのいずれか一方に電気的に接続して形成されている。配線は、例えば、Y 方向に延設された複数の信号用配線や、X 方向に延設された複数の走査用配線が形成され、各 T F T と接続される。なお、T F T は、ゲート電極がソース、ドレイン等よりも上方に形成されたトップゲート型としてもよいし、ゲート電極がソース、ドレイン等よりも下方に形成されたボトムゲート型としてもよい。

20

【 0 1 5 9 】

層間絶縁膜を形成する工程について説明する。

層間絶縁膜形成工程：

上記 T F T 層 2 上に、ポジ型の感光性有機材料からなるレジスト膜 2 6 を塗布した後、そのレジスト膜 2 6 の S D 電極 2 2 上に位置する部分にコンタクトホール 1 3 を形成する。

【 0 1 6 0 】

レジスト膜 2 6 は、スピンコート法等の液層成膜法によって塗布され、T F T 層 2 上の凹凸が埋まることで表面が平坦化される。なお、ディップコート法、スリットコート法、スプレーコート法、ロールコート法、ダイコート法等の液層成膜法によって塗布することもできる。

30

【 0 1 6 1 】

層間絶縁膜 3 上の段差及びコンタクトホール 1 3 の形成にはフォトリソグラフィ法が用いられる。層間絶縁膜 3 には、それぞれ第 1 面 3 a、第 2 面 3 b、第 3 面 3 c が形成されている(図 5 参照)。

【 0 1 6 2 】

これは、露光及び現像処理において、第 2 面 3 b、第 3 面 3 c、及び各コンタクトホール 1 3 を、3 回に分けて別個に形成する。例えば、最初の露光及び現像処理によって第 2 面 3 b を形成した後、再度露光及び現像処理によって第 3 面 3 c を形成し、最後の露光及び現像処理によって各コンタクトホール 1 3 を形成する。

40

【 0 1 6 3 】

本実施の形態では、層間絶縁膜 3 のうち、平面視において、第 1 面 3 a 下の部分が、第 1 電極板群が形成される箇所に相当し、第 2 面 3 b 下の部分が、第 2 電極板群が形成される箇所に相当し、第 3 面 3 c 下の部分が、第 3 電極板群が形成される箇所に相当する。なお、第 2 面 3 b 下の部分が、第 1 電極板群が形成される箇所に相当し、第 3 面 3 c 下の部分が、第 2 電極板群が形成される箇所に相当すると考えることもできる。さらに、第 1 面 3 a 下の部分が、第 1 電極板群が形成される箇所に相当し、第 3 面 3 c 下の部分が、第 2 電極板群が形成される箇所に相当すると考えることもできる。

【 0 1 6 4 】

50

なお、マルチトーンマスクを用いて1回の露光及び現像処理で、層間絶縁膜3上の段差及びコンタクトホール13を形成することもできる。この方法について、図5(a),(b)を用いて説明する。図5(a),(b)は、フォトリソグラフィ法を用いてコンタクトホール13を形成する処理を模式的に示す断面図である。

【0165】

露光処理に用いられるマルチトーンマスク30は、光を透過させる透光部31と、透光を弱める半透光部32と、光を遮る遮光部33とからなる。半透光部32は、露光機の解像度よりも充分微細なパターンを配置し、単位面積当たりに配置する微細パターンの数を調節して透過率を調節したものや、所定の透過率を持った膜をさらに積層して透過率を調節したもの等があり、このような半透光部32によって中間露光を実現している。特に、RGB毎にコンタクトホール13の容積を異ならせる場合のマルチトーンマスク30は、露光機の解像度よりも充分微細なパターンを配置し、単位面積当たりに配置する微細パターンの数を調節して透過率を調節したものが、好適である。

10

【0166】

各コンタクトホール13を形成するために、各透光部31a,31b,31cの開口径は、コンタクトホール13a,13b,13cの下側開口部35a,35b,35c(基板1側の開口)の径と略同じにされている。一方、半透光部32bは、第2面3bと外周の輪郭が略同じにされ、半透光部32cは、第3面3cと外周の輪郭が略同じにされている。そして、マルチトーンマスク30において、透光部31及び半透光部32以外の部分、例えば、第1面3aに対応する部分は遮光部33とされている。

20

【0167】

透光部31は光の透過率が高く、レジスト膜26のうち、透光部31を透過した光が照射された部分は、現像処理後にレジスト膜26の下面側に開口する。

一方、半透光部32b,32cでは照射光が弱められるため、半透光部32を透過した光が照射された部分は上部のみが感光し、現像処理において上部が取り除かれて第2面3b,第3面3cが形成される。なお、半透光部32は、第2面3bを形成する半透光部32bの方が、第3面3cを形成する半透光部32cよりも光の透過率が低くされている。その結果、第2面3bは第3面3cよりも高くなる。

【0168】

上記マルチトーンマスク30による露光により、図5(a)において二点鎖線36によって模式的に示す範囲が感光し、現像処理において溶解し除去される。なお、透光部31及び半透光部32を透過した光は回折によって広がるため、レジスト膜26において、透光部31及び半透光部32よりも広い部分も多少露光され、コンタクトホール13の側面が傾斜する。その結果、コンタクトホール13はテーパ形状になっている。

30

【0169】

この他に、上面が平坦面とされた絶縁膜(有機材料あるいは無機材料)を形成した後、コンタクトホール13を形成しようとする箇所をエッチングで除去する方法によっても、コンタクトホール13を形成することもできる。

【0170】

具体的に説明する。絶縁膜上にフォトレジストを重ねて塗布し、その上に、形成しようとする層間絶縁膜3上の段差面(第2面3bあるいは第3面3c)又はコンタクトホール13に合わせたパターンマスクを重ねる。続いてパターンマスクの上から感光した後、フォトレジストの感光部分(あるいは非感光部分)を現像処理によって取り除くことにより、レジストパターンを形成する。その後、絶縁膜のうちのレジストパターンの開口部分に露出した部分を、例えば、ウェットエッチングによって取り除くことにより、絶縁膜に段差面又はコンタクトホール13が形成される。このような露光及び現像処理を3回行うことでも絶縁膜をパターンニングし、層間絶縁膜3を形成することができる。

40

【0171】

以下に、各色の有機EL素子を形成する工程について説明する。

陽極板形成工程：

50

スパッタリング法により、層間絶縁膜 3 の上に、金属材料（銀、パラジウム及び銅の合金）を厚み 100 ~ 200 nm 程度に薄膜成形し、金属材料膜上に半導体材料（IZO）を厚み 90 nm 程度に薄膜成形する。

【0172】

その後、フォトリソグラフィ法により、行列状に並ぶ平面視矩形の陽極板 5 が形成される。具体的には、半導体材料膜上にレジスト膜を形成し、矩形の陽極板形状が行列状に並べて形成されたマスクパターンを用いてレジスト膜を露光後、TMAH（水酸化テトラメチルアンモニウム）によって露光部分を溶解除去して現像する。さらに、ウェットエッチング（例えば、燐酸、硝酸、酢酸の水溶液によるエッチング）によって、金属材料膜及び半導体材料膜のうちのレジスト膜によって被覆されていない格子状部分を除去してパター

10

【0173】

このとき陽極板 5 は、コンタクトホール 13 の内面にも形成されるので、陽極板 5 はコンタクトホール 13 の内面に沿って凹入し、陽極板 5 に窪み部 23 が形成される。窪み部 23 の底壁部分は、コンタクトホール 13 の下側の開口を通じて、SD 電極 22 に面接触して電気接続される（図 4（c））。

【0174】

画素規制層形成工程：

次に、CVD 法によって、SiON を 100 ~ 300 nm の厚さに成膜する。その後、フォトリソグラフィ法を用い、ドライエッチングでパターニングすることにより、画素規

20

【0175】

ホール注入層形成工程：次に、陽極板 5 及び画素規制層 6 の上に、酸化モリブデンや酸化タングステン等の酸化金属膜を反応性スパッタ法で成膜することにより、ホール注入層 7 を形成する（図 4（d））。

【0176】

画素規制層 6 及びホール注入層 7 も、陽極板 5 に沿っており、部分的に窪み部 23 a , 23 b , 23 c 内に凹入した形態となる。その結果、ホール注入層 7 に窪み部 15 a ~ 15 c が形成される。また、画素規制層 6 及びホール注入層 7 は、サブピクセルにおける膜厚と、窪み部 23 における膜厚とが同程度となる。

30

【0177】

隔壁形成工程：

図 6 に、隔壁形成工程における A - A' 断面を模式的に示す。

隔壁材料として、例えば感光性のレジスト材料、もしくはフッ素系やアクリル系材料を含有するレジスト材料を、層間絶縁膜 3 上に塗布し、レジスト膜 37 を形成する。そのレジスト膜 37 を、モノトーンマスク 38 を用いてフォトリソグラフィ法でパターニングすることによって隔壁 8 a、8 b、8 c を形成する（図 4（f）、図 6（a））。

【0178】

なお、この隔壁形成工程では、次の工程で塗布されるインクに対する撥液性を付与するために、隔壁 8 の表面をアルカリ性溶液や水、有機溶媒等によって表面処理するか、プラズマ処理を施してもよい。

40

【0179】

ホール輸送層形成工程：

次に、ホール輸送層 9 を、インクジェット方式（インクジェット式塗布方法）で形成する（図 4（g））。

【0180】

すなわち、ホール輸送層材料である有機材料と溶媒を所定比率で混合してホール輸送層用のインクを作製し、そのインクを、隣合う隔壁 8 同士の間塗布する。すなわち、公知のインクジェット方式によって、第 1 隔壁である隔壁 8 a と第 2 隔壁である隔壁 8 b との間、第 2 隔壁である隔壁 8 b と第 3 隔壁である隔壁 8 c との間、第 3 隔壁である隔壁 8 c

50

と第4隔壁である隔壁8 a との間の領域に沿って、インクを塗布する。

【0181】

図7は、インクジェット方式で、基板上にホール輸送層形成用のインクを塗布した直後の様子を示す断面模式図である。なお、図7において、ホール注入層7の図示が省略されている。

【0182】

当図において各矢印は、インクジェット装置のノズルから、各素子形成領域において所定の複数箇所にインクを滴下することを示している。つまり、各素子形成領域に滴下される液滴数(例えば、8滴)及び、各素子形成領域における液滴が滴下される複数の箇所が等しくされている。これにより、塗布されたインクは、ホール注入層7の上を全体的に被覆し、コンタクトホール13の存在によって形成された窪み部15の中にも入り込む。

【0183】

ここで、ノズルから吐出する各インク液滴の量は一定であるので、複数の素子形成領域に対して、インクの塗布量が均一になる。つまり、各陽極板5上方に塗布されるインク量も同等であって、そのバラツキは5%以内である。

【0184】

なお、ホール輸送層9を形成するインクをバンク間に充填する方法として、この他に、ディスペンサー法、ノズルコート法、印刷法等を用いてもよく、いずれの方法でも、各陽極板5及びホール注入層7の上に塗布するインクの量は、すべての色のサブピクセルで同等である。

【0185】

このように形成されたインク層を乾燥させることによってホール輸送層9が形成される。

発光層形成工程：

ホール輸送層9の上に、インクジェット方式で発光層10を形成する。この工程は、上記ホール輸送層形成工程と同様であって、発光層形成用の有機発光材料を溶解させたインクを、隣り合う隔壁8同士の間塗布し、乾燥することによって形成するが、用いる有機発光材料が発光色ごとに異なっている。

【0186】

なお、ホール輸送層9の上に、例えば、真空蒸着法によって低分子系有機発光材料からなる発光層10を形成することもできる。また、発光層10を形成するインクをバンク間に充填する方法として、この他に、ディスペンサー法、ノズルコート法、印刷法等を用いてもよい。

【0187】

陰極層形成工程等：

次に、発光層10の表面上に、ITO、IZO等の材料を、スパッタリング法、あるいは真空蒸着法で成膜する。これにより陰極層11を形成する。さらに、陰極層11の表面上に、SiN(窒化シリコン)、SiON(酸窒化シリコン)等の材料をスパッタリング法、あるいは真空蒸着法で成膜することにより、封止層を形成する。

【0188】

以上の工程により、全ての有機EL素子20 a ~ 20 c が形成され、表示パネル100が完成する。

(コンタクトホール13及び窪み部15の容積とホール輸送層9の膜厚について)

表示パネル100において、コンタクトホール13の容積は、青色に対応するコンタクトホール13 a が最も大きく、赤色に対応するコンタクトホール13 c が最も小さく設定されている(13 a > 13 b > 13 c)。よって、窪み部15の容積は、コンタクトホール13 a 上方に形成された窪み部15 a が最も大きく、コンタクトホール13 c 上方に形成された窪み部15 c が最も小さくなる(15 a > 15 b > 15 c)。各色に対応するホール輸送層9 a , 9 b , 9 c は、各陽極板5上方の領域において互いに同じ体積とされているが、窪み部15 a , 15 b , 15 c に入り込む体積(量)が異なっている。

10

20

30

40

50

【 0 1 8 9 】

その結果、青色サブピクセルのホール輸送層 9 a の膜厚（陽極板 5 上の領域における窪み部 1 5 以外の領域での膜厚）が最も薄くなり、緑色サブピクセルのホール輸送層 9 b の膜厚は中間的な厚さになり、赤色サブピクセルのホール輸送層 9 c の膜厚が最も厚くなる。

【 0 1 9 0 】

このように、各窪み部 1 5 a , 1 5 b , 1 5 c の容積を異ならせることで、各ホール輸送層 9 a , 9 b , 9 c の膜厚差を微調節することができる。従って、表示パネル 1 0 0 においては、サブピクセルの色ごとに、ホール輸送層 9 の膜厚を、発光色の波長に合った適値に設定するのが容易である。

10

【 0 1 9 1 】

以下に、陽極板 5 の上方に形成された窪み部 1 5 の容積とホール輸送層 9 の膜厚との関係について詳細に考察する。なお、窪み部 1 5 は、陽極板 5 に形成された窪み部 2 3 に画素規制層 6 やホール注入層 7 が凹入し、窪み部 2 3 の形状に沿って窪むことで形成されている。そして、画素規制層 6 やホール注入層 7 は、C V D やスパッタ法で形成されているため、窪み部 1 5 の形状は窪み部 2 3 と非常に似た形状となる。また、窪み部 2 3 の大きさ（直径および深さ）と比較してホール注入層 7 等の膜厚は遥かに小さく、窪み部 2 3 の容積に対する影響は小さい。

【 0 1 9 2 】

以上のような事情から、窪み部 2 3 と窪み部 1 5 とを同一視しても特に問題はない。よって、正確には、第 1 , 第 2 , 第 3 窪み部は、それぞれ窪み部 2 3 a , 2 3 b , 2 3 c によって構成されているが、便宜的に、第 1 , 第 2 , 第 3 窪み部を、それぞれ窪み部 1 5 a , 1 5 b , 1 5 c が構成していると考えてもよい。

20

【 0 1 9 3 】

また、陽極板 5 の縦方向（Y 方向）の長さと比較して、縦方向に隣合う陽極板 5 間の隙間は非常に小さいため、隙間を考慮せずに計算を行うものとする。なお、サブピクセルにおけるホール輸送層 9 の膜厚を、単にホール輸送層 9 の膜厚と記載することとする。

【 0 1 9 4 】

1 つの素子形成領域で、陽極板 5 上のインク塗布領域（図 3（a）において符号 5 で示す領域）の面積を S、ホール輸送層用のインクの溶質濃度を N とする。また、1 つのインク塗布領域に塗布されるインク（図 7 中の斜線領域 C）の塗布量を V0、陽極板 5 上に形成される窪み部 1 5 の容積を V1（各色に対応する窪み部 1 5 a , 1 5 b , 1 5 c の容積を、それぞれ V1a、V1b、V1c）とする。

30

【 0 1 9 5 】

図 8（a）,（b）,（c）は、それぞれ、インク塗布領域にインクが塗布された状態（左側）と、インクが乾燥した状態（右側）とを、図 7 よりも大幅に簡略化して示す模式図である。以下には、インク塗布領域、窪み部 1 5 等を図 8 に示す単純なモデルにして、窪み部 1 5 の容積とホール輸送層 9 の膜厚との関係について考察する。なお、図 8 において、陽極板 5、画素規制層 6 等の図示が省略されている。

【 0 1 9 6 】

（1）窪み部の有無によるホール輸送層 9 の膜厚の違いについて

まず、窪み部 1 5 の容積とホール輸送層 9 の膜厚との関係について述べる。

図 8（a）に、窪み部 1 5 が形成されていないと仮定した場合におけるインクの乾燥前後の状態を示す。仮に陽極板 5 の上面全てが平坦であり、窪み部がないとすると、陽極板 5 の上方に塗布されるインク層の仮想高さ H0 は、塗布量 V0 を面積 S で除して得られる。

【 0 1 9 7 】

$$H0 = V0 / S \quad \dots (1 - 1)$$

乾燥後に形成されるホール輸送層 9 の仮想膜厚 h0 は、インク層の仮想高さ H0 に溶質濃度 N を乗じて求める。

【 0 1 9 8 】

40

50

$$h_0 = N \cdot H_0 \\ = N \cdot V_0 / S \quad \dots (1-2)$$

一方、図8(b)、(c)に、窪み部15が形成されている場合におけるインクの乾燥前後の状態を示す。なお、当図において、窪み部15内に充填されたインクが乾燥される部分と、窪み部15上方のインク層が乾燥される部分とが区別して示されている。これについては、後に説明する。

【0199】

陽極板5上方に窪み部15(体積V1)が形成されている場合、塗布されたインクの一部がその窪み部15に充填される。なお、図7中、斜線領域Dのように窪み部15の全体にインクが充填されるものとする。また、塗布されたインクの上面に多少の凹凸が生じる場合があるが、平坦であるとみなして概算する。

10

【0200】

そうすると、サブピクセルにおけるインク層の高さH(Ha, Hb, Hc)は、インクの塗布量V0から窪み部15への充填量V1だけ差し引いたインク残量(V0 - V1)を、窪み部がない陽極板上に塗布した場合における高さと同じとみなすことができる(図8(b)参照)。

【0201】

従って、インク層の高さHは、インク残量(V0 - V1)を面積Sで除して、次式によって得られる。

$$H = (V_0 - V_1) / S \quad \dots (1-3)$$

20

インク乾燥後のホール輸送層9の膜厚h(ha, hb, hc)は、インク層の高さHに、中間層用のインクの溶質濃度Nを乗じることで求められる。

【0202】

$$h = N \cdot H \\ = N (V_0 - V_1) / S \quad \dots (1-4)$$

図8の(a)と(b)とを比較すると、インクが窪み部15に充填されることによって、サブピクセルにおけるインク層の高さHが、仮想高さH0(図8(b)において直線Jで示す)よりも小さくなるのが分かる。その結果、乾燥後にホール輸送層9の膜厚hが、仮想膜厚h0よりも小さくなるのである。

【0203】

30

ここで、陽極板5に窪み部15が形成されていないと仮定した場合、前述のようにホール輸送層9の仮想膜厚h0は、N・V0/Sである。よって、仮想膜厚h0との比較において、窪み部15の存在によりホール輸送層9の膜厚hが減少した量Eは、次式となる。

【0204】

$$E = h_0 - h \\ = N \cdot V_0 / S - N (V_0 - V_1) / S \\ = N \cdot V_1 / S \quad \dots (1-5)$$

すなわち、ホール輸送層9の仮想膜厚h0に対する膜厚hの減少量Eは、原則的に、窪み部15の容積に基づいて定まるのである。よって、窪み部15の容積(V1)を大きくすれば、ホール輸送層9の膜厚hの仮想膜厚h0に対する減少量Eを大きくすることができる。

40

【0205】

そして、各色の窪み部15の容積V1a, V1b, V1cの大小は、V1a > V1b > V1cとなっている。したがって、例えば、インクの塗布量V0及び溶質濃度Nを同じにした場合、青色のサブピクセルのホール輸送層9aの膜厚が最も薄くなり、赤色のサブピクセルのホール輸送層9cの膜厚が最も厚くなる。

【0206】

(2) 各色に対応する窪み部15の容積の違いと、ホール輸送層9の膜厚の差について図8(b)、(c)には、インク層の高さHa, Hbと、ホール輸送層9a, 9bの膜厚ha, hbとを示す。なお、図8では、簡略化のため、陽極板5等の図示を省略し、窪

50

み部 15 の断面形状を矩形にしている。

【 0 2 0 7 】

ここで、代表的に、異なる色に対応する窪み部 15 a , 15 b 間の容積の差 V_{1ab} と、ホール輸送層 9 の膜厚 h_a , h_b の膜厚差 h_{ab} との関係について述べる。

なお、インクの塗布量 V_0 及び溶質濃度 N は、各色のインク塗布領域で互いに等しくされているものとする。この場合に、例えば、青色のサブピクセルにおけるホール輸送層 9 a の膜厚 h_a と、緑色のサブピクセルにおけるホール輸送層 9 b の膜厚 h_b との膜厚差 h_{ab} は、次式によって得られる。

【 0 2 0 8 】

$$\begin{aligned} h_{ab} &= h_a - h_b \\ &= N (V_0 - V_{1a}) / S - N (V_0 - V_{1b}) / S \\ &= N (V_{1b} - V_{1a}) / S \\ &= N \cdot V_{1ab} / S \quad \dots (2 - 1) \end{aligned}$$

すなわち、各色のインク塗布領域でインク量 V_0 及び溶質濃度 N が等しい場合、上記膜厚差 h_{ab} は、原則的に、青色に対応する窪み部 15 a の容積と、緑色に対応する窪み部 15 b の容積との差 V_{1ab} に比例するのである。よって、窪み部 15 a , 15 b , 15 c 間の容積の差 V_1 (例えば、 $V_{1a} - V_{1b}$) を調節することで、その容積の差 V_1 に応じて、各色に対応するホール輸送層 9 の膜厚 h_a , h_b , h_c の膜厚差 h (例えば、 $h_a - h_b$) を調節することができる。ここで、窪み部 15 a の容積 V_{1a} は、窪み部 15 b の容積 V_{1b} よりも大きいため、容積 V_{1b} から容積 V_{1a} を引くと負の値となるが、これは、膜厚 h_a が膜厚 h_b よりも小さいことを示している。

【 0 2 0 9 】

なお、対応色によってインクの塗布量 V_0 や溶質濃度 N が異なっても、同様の原理で膜厚差 h を調節することができる。

(3) ホール輸送層 9 の膜厚差の調節単位について

各窪み部 15 の大きさは、層間絶縁膜 3 に形成するコンタクトホール 13 の大きさによって規定されており、後述するように微調節可能である。従って、窪み部の体積 V_{1a} , V_{1b} , V_{1c} は、インク液滴 1 滴の体積と比べて、細かい単位で調節することができるので、対応色が異なるホール輸送層 9 の膜厚差を微調節できる。

【 0 2 1 0 】

まず、比較例として、サブピクセルの色ごとに塗布するインク液滴の滴数を変える方法で膜厚を調節した場合について説明する。各インク塗布領域に塗布するインクの液滴数を M 滴とすると、インク 1 滴の体積は、インクの塗布量 V_0 をインクの液滴数 M で除した値 (V_0 / M) となる。したがって、各インク塗布領域に塗布するインク液滴の滴数を 1 滴増減させた場合 (例えば、 M 滴と $M + 1$ 滴とを比較した場合)、形成される中間層の膜厚は $N (V_0 / M) / S$ だけ増減するので、 $N (V_0 / M) / S$ 単位でしか膜厚差を調節できない。

【 0 2 1 1 】

次に、本実施形態によれば、例えば、窪み部 15 a , 15 b , 15 c 間の容積の差 (例えば、 $V_{1a} - V_{1b}$) を、インク 1 滴の体積 (V_0 / M) よりも小さい単位で調節することができる (例えば、インク半滴分の体積 $V_0 / 2 M$)。よって、ホール輸送層 9 の膜厚差 h を、例えば $N (V_0 / 2 M) / S$ として、インク液滴数を 1 滴増減させた場合の膜厚差よりも小さく設定することができる。さらに、ホール輸送層 9 の膜厚差 h を、例えば、インク液滴数を n 滴増減させた場合の膜厚差よりも大きく、液滴数を $n + 1$ 滴増減させた場合の膜厚差よりも小さく設定することもできる。

【 0 2 1 2 】

したがって、例えば、(i) 青色サブピクセルのホール輸送層 9 a の膜厚 h_a と、緑色サブピクセルのホール輸送層 9 b の膜厚 h_b との膜厚差 h_{ab} を、(ii) 青色サブピクセルに滴下するインクの液滴数を n 滴増加させた場合のホール輸送層 9 a の膜厚 h_a の増加分よりも大きく、かつ、前記インクの液滴数を $n + 1$ 滴増加させた場合のホール輸送層 9 a

の膜厚 h_a の増加分よりも小さくすることができる。

【0213】

(4) ホール輸送層9のうちの窪み部15に入り込んだ部分について

図8(b), (c)に示すように、窪み部15内のホール輸送層9の膜厚は、概ねサブピクセルにおけるホール輸送層9の膜厚よりも厚くなる。これは、主に、窪み部15に充填されたインクによるものである。

【0214】

ここで、図7の下側の図において、窪み部15に入り込むホール輸送層9の量(体積) v_3 は、直線Eと直線Fとに挟まれた部分の体積を指す。つまり、窪み部15に入り込むホール輸送層9の量は、正確には、平面視において窪み部15と同じ領域に形成されているホール輸送層9の量と表現することができる。

10

【0215】

そして、図8に戻り、窪み部15に入り込むホール輸送層9の量(体積) v_3 は、窪み部15内に充填された第1インク部分41(体積 V_1)が乾燥されてなる第1部分42の体積 v_1 と、インク層のうちの窪み部15上方に位置する第2インク部分43(体積 V_2)が乾燥されてなる第2部分44の体積 v_2 との和となる。

【0216】

$$v_3 = v_1 + v_2 \quad \dots (3-1)$$

なお、体積 v_1 と体積 v_2 とは、次式で表わされる。

$$v_1 = N \cdot V_1 \quad \dots (3-2)$$

$$v_2 = N \cdot V_2 \quad \dots (3-3)$$

20

ここで、図8(b), (c)に示すように、窪み部15に入り込んだホール輸送層9のうち、第2部分44の元となる第2インク部分43は、サブピクセルにおけるインク層の高さ H に応じて変化するだけであり、ホール輸送層9の膜厚 h の変化に寄与していないと考えられる。また、式(1-5)からも明らかである。

【0217】

よって、窪み部15に入り込んだホール輸送層9の体積 v_3 のうち、ホール輸送層9の膜厚 h の変化に寄与するのは第1部分42の体積 v_1 である。そして、窪み部15の容積 V_1 が調節される結果、第1部分42の体積 v_1 が適切化され、ホール輸送層9の膜厚 h を適切なものとするすることができる。

30

【0218】

さらに、各色に対応する第1インク部分41a, 41b, 41c(41cの図示は省略する)の容積 V_{1a} , V_{1b} , V_{1c} の差を微調節することで、第1部分42の体積 v_{1a} , v_{1b} , v_{1c} の差が適切化され、各色のサブピクセルにおけるホール輸送層9a, 9b, 9cの膜厚差が微調節されている。

【0219】

しかしながら、実際に、窪み部15に入り込んだホール輸送層9を第1部分42と第2部分44とに区別することは困難である。よって、サブピクセルにおけるホール輸送層9の量に基づいて、第2部分44の体積 v_2 に相当する体積相当値 v_2' を算出することとする。

40

【0220】

ここで、第2インク部分43の高さは、サブピクセルにおけるインク層45の高さ H と同じである。よって、窪み部15の上面積が S_1 であるとすると、サブピクセルにおいて、ホール輸送層9の面積 S_1 当たり(符号46で例示する部分)の体積 v_4 が、第2部分44の体積 v_2 に相当し、体積相当値 v_2' になると考えられる。

【0221】

そこで、上記体積 v_4 は、サブピクセルにおけるホール輸送層9の膜厚 h に面積 S_1 を乗じて算出することができる。なお、膜厚 h は、例えば、サブピクセルにおけるホール輸送層9の膜厚の平均的な膜厚とすることができる。具体的には、例えば、サブピクセルにおけるホール輸送層9の膜厚を複数箇所測定し、その平均値とすることができる。

50

【0222】

$$\begin{aligned} v2' &= v4 \\ &= h \cdot S1 \quad \dots (3-4) \end{aligned}$$

よって、第2インク部分43の体積相当値 $v2'$ が得られ、第1インク41の体積相当値 $v1'$ が算出できる。なお、合計体積 $v3$ の相当値 $v3'$ は、例えば、窪み部15内に入り込んだホール輸送層9の断面に基づいて算出することができる。具体的には、例えば、窪み部15の中心軸を含む断面が得られる場合は、ホール輸送層9の断面形状を中心軸周りに1回転させた回転体の体積を相当値 $v3'$ とすることができる。

【0223】

$$\begin{aligned} v1' &= v3' - v2' \\ &= v3' - h \cdot S1 \quad \dots (3-5) \end{aligned}$$

10

なお、理想的には、体積相当値 $v1'$ と、窪み部15aの容積 $V1$ に溶質濃度 N を乗じて得られた体積 $v1$ とは、同程度の値となる(例えば、 $\pm 10\%$ の範囲内)。

【0224】

窪み部15の上面積 $S1$ は、後述するコンタクトホール13の上面積と同じように定義することもできる。つまり、窪み部15の周縁部の最も高い位置から約10%下がった位置における窪み部15の直径で規定される円の面積としてもよい。

【0225】

本実施の形態において、[i]前記第1コンタクトホール(13a)は、前記第2コンタクトホール(13b)より深く、かつ、容積が大きく($V1a > V1b$)、[ii]前記第1色用の電極板(5a)上の領域に対応する前記第1有機機能層(9a)の体積(例えば、 $N \cdot V0$)は、前記第2色用の電極板(5b)上の領域に対応する前記第2有機機能層(9b)の体積(例えば、 $N \cdot V0$)と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、[iii]前記第1有機機能層の膜厚(h_a)は、前記第1コンタクトホールに対応する第1窪み部(15a)に入り込む前記第1有機機能層の量($v3a$)が前記第2コンタクトホールに対応する第2窪み部(15b)に入り込む前記第2有機機能層の量($v3b$)より多いことにより、前記第1窪み部以外の前記第1色用の電極板上の領域(例えば、青色のサブピクセルにおける9a)において、前記第2窪み部以外の前記第2色用の電極板上の領域(例えば、緑色のサブピクセルにおける9b)に形成された前記第2有機機能層の膜厚(h_b)より薄い。

20

30

【0226】

また、本実施の形態において、[i]前記第1コンタクトホール(13a)は、前記第2コンタクトホール(13b)より深く、かつ、容積が大きく($V1a > V1b$)、[ii]第1色用の電極板(5a)の第1窪み部(15a)に入り込む前記第1有機機能層(9a)の量($v3a$)と、第1色用の電極板の第1窪み部以外の部分に対応する前記第1有機機能層(例えば、青色のサブピクセルにおける9a)が、平面視において前記第1窪み部と同じ広さ(上面積 $S1$)当たりに形成された量($v2a$)との差($v3a - v2a = v1a$)は、[iii]第2色用の電極板(5b)の第2窪み部(15b)に入り込む前記第2有機機能層(9b)の量($v3b$)と、第2色用の電極板の第2窪み部以外の部分に対応する前記第2有機機能層(例えば、緑色のサブピクセルにおける9b)が、平面視において前記第2窪み部と同じ広さ(上面積 $S1$)当たりに形成された量($v2b$)との差($v3b - v2b = v1b$)よりも大きい、ということもできる。

40

【0227】

なお、上記括弧内の体積 $v1$ 、 $v2$ 、 $v3$ を、前述の体積相当値 $v1'$ 、 $v2'$ 、 $v3'$ とすることができる。

また、本実施の形態において、青色のサブピクセルにおけるホール輸送層9aが前記第1有機機能層に相当し、緑色のサブピクセルにおけるホール輸送層9bが前記第2有機機能層に相当し、赤色のサブピクセルにおけるホール輸送層9cが前記第3有機機能層に相当する。

【0228】

50

ここで、青色のサブピクセルにおけるホール輸送層 9 a が前記第 1 有機機能層に相当し、赤色のサブピクセルにおけるホール輸送層 9 c が前記第 2 有機機能層に相当すると考えることもできる。さらに、緑色のサブピクセルにおけるホール輸送層 9 b が前記第 1 有機機能層に相当し、赤色のサブピクセルにおけるホール輸送層 9 c が前記第 2 有機機能層に相当すると考えることもできる。

【0229】

(4) 次に具体的な数値例を入れて考察する。

例えば、1つのサブピクセルで、陽極板 5 上のインク塗布領域(図 3(a)の符合 5 で示す領域)のサイズを縦 300 μm、横 70 μm とすると、陽極板 5 上のインク塗布領域の面積 $S = 21000 \mu\text{m}^2$ となる。

10

【0230】

また、中間層用のインクの溶質濃度 N を 0.02 (2 vol%) とし、インクジェットで吐出される 1 滴あたりの液滴量が 3 pL で、各サブピクセルの陽極板 5 の上に 7 滴ずつ充填するものとする、各インク塗布領域に充填されるインクの充填量 $V0 = 21 \text{ pL}$ ($21000 \mu\text{m}^3$) となる。

【0231】

陽極板 5 に窪み部がないとすると、陽極板 5 の上に充填されるインク層の仮想高さ $H0$ は、 $V0/S = 1 \mu\text{m}$ ($= 1000 \text{ nm}$) となり、乾燥後に形成されるホール輸送層 9 の膜厚 $h0$ は、次式によって得られる。

【0232】

$$h0 = N \cdot H0 \\ = 0.02 \mu\text{m} = 20 \text{ nm} \quad \dots (4-1)$$

20

ここで、青色に対応する窪み部 15 a は、上面半径が下面半径よりも大きな円錐台形状とし、高さ T を 6 μm、上面半径 r_1 を 18 μm、下面半径 r_2 を約 14.5 μm、側面の傾斜角度が 60 [°] (XY 平面に対する傾斜角度) とした。よって、窪み部 15 a の容積 $V1a$ は、次式で求められ、 $V1a$ が 3.14 とすると、 $4994 \mu\text{m}^3$ (4.994 pL) となる。

【0233】

$$V1 = \frac{1}{3} \cdot T (r_1^2 + r_1 \cdot r_2 + r_2^2) / 3 \quad \dots (4-2)$$

その結果、青色サブピクセルのホール輸送層 9 a の膜厚 $h a$ は、次式によって得られる

30

【0234】

$$h a = N (V0 - V1a) / S = 15.2 \text{ nm} \quad \dots (4-3)$$

緑色に対応する窪み部 15 b も同様に、上面半径が下面半径よりも大きな円錐台形状であり、高さを 4.5 μm、上面半径 18 μm、下面半径を約 15.4 μm、側面の傾斜角度が 60 [°] (XY 平面に対する傾斜角度) とした。よって、窪み部 15 b の容積 $V1b$ は、 $V1b$ が 3.14 とすると、 $3949 \mu\text{m}^3$ (3.949 pL) となる。

【0235】

その結果、緑色サブピクセルのホール輸送層 9 b の膜厚 $h b$ は、次式によって得られる

40

$$h b = N (V0 - V1b) / S = 16.2 \text{ nm} \quad \dots (4-4)$$

赤色に対応する窪み部 15 c も同様に、上面半径が下面半径よりも大きな円錐台形状であり、高さを 3 μm、上面半径 18 μm、下面半径を約 16.3 μm、側面の傾斜角度が 60 [°] (XY 平面に対する傾斜角度) とした。よって、窪み部 15 c の容積 $V1c$ は、 $V1c$ が 2.773 μm³ (2.773 pL) となる。その結果、赤色サブピクセルのホール輸送層 9 c の膜厚 $h c$ は、次式によって得られる。

【0236】

$$h c = N (V0 - V1c) / S = 17.4 \text{ nm} \quad \dots (4-5)$$

よって、青色サブピクセルのホール輸送層 9 a の膜厚 $h a$ と、緑色サブピクセルのホール輸送層 9 b の膜厚 $h b$ との膜厚差 $h a b$ は、1.0 nm となる。また、膜厚 $h b$ と膜

50

厚 h_c との膜厚差 h_{bc} は、約 1.1 nm となる。さらに、膜厚 h_a と膜厚 h_c との膜厚差 h_{ac} は、約 2.1 nm となる。上記の場合、コンタクトホール 13 の容積差 V_1 は、それぞれ V_{1ab} (青色と緑色) 及び V_{1bc} (緑色と赤色) が $1045 \mu\text{m}^3$ (約 1 pL) 程度、 V_{1ac} (青色と赤色) が $2221 \mu\text{m}^3$ (約 2 pL) 程度である。

【0237】

このようにして、各色のサブピクセル間においてホール輸送層 9 の膜厚差を、微小単位 (例えば、 1 nm 以下) で調節することができる。

一方、比較例では、1つのサブピクセルあたりに充填するインク液滴の滴数を1滴増減させた場合、形成される中間層の膜厚は約 2.9 nm だけ増減するので、約 2.9 nm 単位でしか膜厚を調節できない。なお、インクジェット装置から吐出されるインク1滴の体積及びインク塗布領域の面積によって、上記 2.9 nm の大きさは変化する。

【0238】

以上のように、本実施形態の表示パネル 100 の製法によれば、各色サブピクセルに形成する窪み部 15a, 15b, 15c の体積をインク液滴の体積よりも細かく微調節することによって、各色サブピクセルのホール輸送層 9 の膜厚差を比較的容易に微調節できる。その結果、ホール輸送層 9 の膜厚を、サブピクセルの色ごとに、発光色の波長に合った適値に設定して効率よく光を取り出すようにすることが容易になる。

【0239】

なお、上記計算例において、コンタクトホール 13 の側面の傾斜 (テーパ角度) を 60 度としたが、 60 度に限られず、任意の傾斜角度とすることができる。さらに、コンタクトホール 13 は、連続的に狭くなる形状とされていたが、任意の形状とすることができる。

【0240】

また、上記膜厚差 h は、 1 nm や 2 nm に限られず、例えば、条件に応じて 1 nm 未満とすることや、 3 nm 以上にすることができる。また、コンタクトホール 13 の上面半径も $18 \mu\text{m}$ に限られず、例えば $20 \mu\text{m}$ 以上にする等、任意の値にしてもよい。

【0241】

ここで、コンタクトホール 13 の上側開口部は、隔壁 8 の高さや形状に影響を及ぼさないようにするため、平面視において隔壁 8 が形成された領域と離間して形成されていることが好ましい。

【0242】

対応色が異なるコンタクトホール 13 の容積差 V_1 は、コンタクトホール 13a の容積の誤差よりも大きいことが好ましい。例えば、コンタクトホール 13a の容積が $5000 \mu\text{m}^3$ で、誤差が 10% である場合は、例えば、容積差 V_{1ab} が $500 \mu\text{m}^3$ を超えていることが好ましい。

【0243】

(上面積について)

ここで、コンタクトホール 13 の上面積について説明する。

本実施の形態において、各色に対応するコンタクトホール 13a, 13b, 13c の上面積が実質同一とされている。また、コンタクトホール 13 の上面積は、コンタクトホール 13 の周縁部の最も高い位置から約 10% 下がった位置におけるコンタクトホール 13 の直径で規定される円の面積とされる。

【0244】

図 9 (a), (b), (c) は、それぞれコンタクトホール 13 の断面を模式的に示す図である (なお、コンタクトホール 13b の断面を代表的に示している)。なお、各図におけるコンタクトホール 13 の形状は、周縁部において異なっている。このような場合に、コンタクトホール 13 の直径をどのように規定するかを説明する。

【0245】

まず、「コンタクトホール 13 の周縁部の最も高い位置」と「コンタクトホール 13 の深さ」とについて説明する。

図9(a)では、コンタクトホール13の周縁部の最も高い位置は、層間絶縁膜3の上面50と同じ高さ(直線O1)になる。この場合、コンタクトホール13の深さP1は、上面50とコンタクトホール13の底面(SD電極22の上面)との間の垂直距離となる。なお、垂直距離は、積層方向(Z方向)における距離である。

【0246】

図9(b)では、コンタクトホール13の開口縁が湾曲部51になっている。このような場合は、湾曲部51がコンタクトホール13の周縁部を構成していると考え、湾曲部51の最も高い位置、すなわち、層間絶縁膜3の上面50の高さ位置となる。この場合のコンタクトホール13の深さP2は、図9(a)と同様である。

【0247】

図9(c)では、コンタクトホール13に隣接して隆起部52が形成されている。図のように、隆起部52の側面53がコンタクトホール13の側面の一部とみなせる場合には、隆起部52の頂部54の位置が、コンタクトホール13の周縁部の最も高い位置に該当する。この場合、コンタクトホール13の深さP3は、隆起部52の頂部54からコンタクトホール13の底面までの垂直距離となる。

【0248】

ところで、本実施の形態において、各色に対応するコンタクトホール13a, 13b, 13cの深さが異なっている。このような場合、3つのコンタクトホール13a, 13b, 13cの深さの平均値 P_{Ave} をコンタクトホール13の深さとして用いることとする。

【0249】

次に、「コンタクトホール13の周縁部の最も高い位置から約10%下がった位置」と「コンタクトホール13の直径」とについて説明する。

最も高い位置から約10%下がった位置とは、最も高い位置から深さの平均値 P_{Ave} の約10%下がった位置とされる。なお、約10%とは、 $\pm 1\%$ の誤差範囲を含み、9%以上かつ11%以下の範囲内のいずれかの値とされる。

【0250】

図9(a), (b), (c)において、コンタクトホール13の周縁部の最も高い位置O1, O2, O3から、深さの平均値 P_{Ave} の10%下がった位置を、それぞれ直線Q1, Q2, Q3で示す。

【0251】

そして、各図の断面において、直線Q1, Q2, Q3の各々とコンタクトホール13の側面との2つの交点の距離が、それぞれコンタクトホール13の直径 d_1, d_2, d_3 となる。その結果、コンタクトホール13の上面積は、例えば、直径 d_1 の円の面積となる。

【0252】

(光路長について)

図10は、有機EL素子20内での光の光路を模式的に示す断面図である。当図には、発光層10から陰極層11側に直接出射する直出光61と、陽極板5側で反射してから出射する反射光62とが示されている。なお、当図において、陽極板5を、金属層63と透明電極層64(IZO)とに分けて示している。この場合、陽極板5の反射面は、透明電極層64側の金属層63の主面によって構成されている。

【0253】

図10では、例えば、ホール輸送層9、ホール注入層7、及び透明電極層64の光路長に対して、有機EL素子20内での光の共振条件を最適化することができる。このような構造をキャビティあるいはキャビティ構造と称する。

【0254】

本実施の形態において、ホール輸送層9の膜厚だけで光路差を調節してもよいし、ホール輸送層9に加え、ホール注入層7、透明電極層64等の膜厚も調節して光路差を調節してもよい。

10

20

30

40

50

【 0 2 5 5 】

コンタクトホール13の容積差を決定する方法について簡単に述べる。例えば、有機EL表示パネルの試作品を製造し、光の共振条件を色ごとに最適化するために各色の有機機能層の膜厚差をどのように変えるか、あるいは、有機機能層の膜厚差を維持しつつ全体的に膜厚を変化させるかを決定する。そして、試作品と同じ製造条件（インクの塗布条件）のもと、コンタクトホール13の容積を変更して有機EL表示パネルを製造する。このようにして、有機EL素子内での光の共振条件が最適化され、発光効率の高い有機EL表示パネルが得られる。

【 0 2 5 6 】

<変形例>

前記実施の形態1において、各色に対応するコンタクトホール13の容積を変えることで、ホール輸送層9の膜厚差を微調節していたが、有機機能層の一例である発光層10の膜厚差を微調節することもできる。

【 0 2 5 7 】

本変形例では、各コンタクトホール13a, 13b, 13c等の容積差によって、各色のサブピクセルにおける発光層10a, 10b, 10cの膜厚差が生じる。その結果、各色の発光層10に適切な輝度や色度が得られやすくなる。あるいは、有機EL素子20内における光の共振条件が適切化され、光の取出し効率が向上する。なお、各色のサブピクセルに塗布する有機発光材料を含むインクの液滴数を異ならせた上で、さらに、コンタクトホール13の容積差によって膜厚差を微調節してもよい。

【 0 2 5 8 】

なお、本変形例において、ホール輸送層を、蒸着法やスパッタ法によって形成することができる。また、ホール輸送層を前述のインクジェット法等によって形成してもよいし、省略してもよい。

【 0 2 5 9 】

ところで、ホール注入層をインクジェット方式によって形成し、その膜厚差を微調節してもよい。この場合は、ホール注入層の材料として、PEDOT-PSS、芳香族アミン系高分子材料、ポリフェニレンビニレン等の有機材料を用いることができる。

【 0 2 6 0 】

<実施の形態2>

前記実施の形態において、層間絶縁膜3の上面に段差が形成されることでコンタクトホール13の深さが異なっていた。それに対して、層間絶縁膜の上面を平坦にしておき、各色に対応するコンタクトホールが形成される箇所の基板の上面高さを変えることによって、層間絶縁膜の膜厚差を変えてコンタクトホールの深さを変えることができる。

【 0 2 6 1 】

図11は、本実施の形態の表示パネル80を模式的に示す断面図である。この図は、図3(a)のA-A'断面に相当する断面を示している。なお、発光層、陰極層等の図示が省略されている。

【 0 2 6 2 】

本実施の形態において、基本的に、前記実施の形態1の図3(a), (c)に示した構造が採用されており、基板や層間絶縁膜の断面形状が前記実施の形態1と異なるものとされている。なお、窪み部15については、前記実施の形態1と同じ符号を用いている。

【 0 2 6 3 】

本実施の形態の段付き基板81には、階段状の段差が形成されている。段付き基板81は、平坦基板82に段差形成部83が積層されてなる。

段付き基板81上には、TF T層84（二点鎖線で模式的に示す）が形成されており、TF T層84に含まれる各TF TのSD電極85を代表的に示す。

【 0 2 6 4 】

TF T層84上には、層間絶縁膜86が形成されている。層間絶縁膜86には、各SD電極85上の位置に上面積が実質同一のコンタクトホール87が形成されている。層間絶

10

20

30

40

50

縁膜 86 の上面 86 a は、コンタクトホール 87 が形成されている部分を除いて平坦面とされている。

【0265】

層間絶縁膜 86 上には、青緑赤にそれぞれ対応する有機 EL 素子 90 a , 90 b , 90 c が形成されている。各有機 EL 素子 90 において、陽極板 91 , 画素規制層 92 , ホール注入層 93 及びホール輸送層 94 がこの順に積層形成されている。また、X 方向に隣合う有機 EL 素子 90 は、隔壁 95 によって区画されている。

【0266】

段付き基板 81 の下部を構成する平坦基板 82 は、前記実施の形態における基板 1 と同じものとする事ができる。

段付き基板 81 の上部を構成する段差形成部 83 は、底面（平坦基板 82 側の主面）が平坦にされる一方、上面が階段状にされている。また、段差形成部 83 は、Y 方向において膜厚が均一とされる一方、X 方向において階段状に膜厚が変化している。

【0267】

そして、段差形成部 83 の上面は、最下段の面である第 1 面 83 a、中間高さの第 2 面 83 b、最上段の面である第 3 面 83 c を含み、これら 3 つの面の間は斜面とされている。また、第 1 面 83 a、第 2 面 83 b、及び第 3 面 83 c（以下、第 1 面 83 a 等と略記する）は、平坦基板 82 の主面に平行にされ、Y 方向に延びる帯状の平面形状を成している。

【0268】

さらに、第 1 面 83 a 等の各々は、各色の有機 EL 素子 90 に対応している。第 1 面 83 a には、青色に対応する有機 EL 素子 90 a 用の SD 電極 85 a が形成され、第 2 面 83 b には、緑色に対応する有機 EL 素子 90 b 用の SD 電極 85 b が形成され、第 3 面 83 c には、赤色に対応する有機 EL 素子 90 c 用の SD 電極 85 c が形成されている。

【0269】

その結果、各 SD 電極 85 の上面の高さ位置は、SD 電極 85 a が最も低く、SD 電極 85 b が中間的な高さとなり、SD 電極 85 c が最も高くなる。

したがって、SD 電極 85 上に形成されたコンタクトホール 87 の深さは、SD 電極 85 a 上に形成されたコンタクトホール 87 a が最も深くなり、SD 電極 85 b 上に形成されたコンタクトホール 87 b が中間的な深さとなり、SD 電極 85 c 上に形成されたコンタクトホール 87 c が最も浅くなる。

【0270】

各コンタクトホール 87 a , 87 b , 87 c の上面積は実質同一とされているので、各コンタクトホール 87 の深さが大きいほど容積が大きくなる。

そして、各色に対応するコンタクトホール 87 a , 87 b , 87 c 間の容積差を微調節することで、前記実施の形態 1 と同様に、インクジェット方式によって形成されるホール輸送層 94 の膜厚差を微調節することができ、各色の光の波長に適した膜厚差を実現することができる。

【0271】

本実施の形態において、前記「TF T 基板の第 1、第 2 及び第 3 コンタクトホールの各々の底面に対応する箇所」は、SD 電極 85 a , 85 b , 85 c の上方であって、前記層間絶縁膜の底部が相当する。また、SD 電極 85 a , 85 b , 85 c の上面が、それぞれ、前記「TF T 基板の第 1、第 2 及び第 3 コンタクトホールの各々の底面」を形成している、と考えることもできる。

【0272】

（表示パネルの製造方法）

まず、例えば、ガラス製の平坦基板 82 を準備する。

段差面形成工程：

図 12 (a) , (b) , (c) は、段差面形成工程を模式的に示す断面図である。

【0273】

10

20

30

40

50

平坦基板 8 2 上に、例えば、CVD 法により無機絶縁膜 9 6 (酸化シリコン、窒化シリコン等)を形成する(図 1 2 (a))。

フォトリソグラフィ法により、無機絶縁膜 9 6 の上部をエッチングし、階段状の段差を形成する(図 1 2 (b), (c))。

【0274】

具体的には、無機絶縁膜 9 6 上に感光性の第 1 レジスト膜を形成した後、露光、現像処理によって、第 1 レジスト膜のうちの第 1 面 8 3 a, 第 2 面 8 3 b が形成される領域を覆う部分を開口させる。そして、無機絶縁膜 9 6 のうちの第 1 レジスト膜から露出した部分を、第 2 面 8 3 b の深さまでエッチング(例えば、ウェットエッチング)する。この処理によって、無機絶縁膜 9 6 のうちの第 1 面 8 3 a 及び第 2 面 8 3 b が形成される領域の高さが、第 3 面 8 3 c よりも低くなる(図 1 2 (b))。また、この処理によって、第 2 面 8 3 b が形成される。

10

【0275】

引き続き、一旦第 1 レジスト膜を除去した後、再度新たに第 2 レジスト膜を形成し、露光、現像処理によって、第 2 レジスト膜のうちの第 1 面 8 3 a が形成される領域を覆う部分を開口させる。そして、無機絶縁膜 9 6 のうちの第 2 レジスト膜の開口から露出した部分を、第 1 面 8 3 a の深さまでエッチングする。この処理によって、第 1 面 8 3 a が形成される(図 1 2 (c))。

【0276】

以上の処理によって段差形成部 8 3 が形成され、段付き基板 8 1 が作製される。

20

なお、平坦基板 8 2 上に無機絶縁膜 9 6 を形成することなく、平坦基板 8 2 をエッチングすることによって、平坦基板 8 2 上に段差を形成してもよい。

【0277】

なお、無機絶縁膜 9 6 を感光性樹脂材料からなる絶縁膜としてもよい。

この場合は、例えば、前記実施の形態 1 における層間絶縁膜形成工程のように、フォトリソグラフィ法により、マルチトーンマスクを用いて絶縁膜を露光した後、現像処理により絶縁膜の感光部分(あるいは非感光部分)を除去して段差面を形成することができる。

【0278】

ここで、マルチトーンマスクは、例えば、第 1 面 8 3 a が形成される領域に透光部が対応し、第 2 面 8 3 b が形成される領域に半透光部が対応し、第 3 面 8 3 c 形成される領域に遮光部が対応するものとされる。

30

【0279】

TFT 層形成工程：

段差形成部 8 3 上に、公知の製造方法(例えば、特開 2 0 0 3 - 2 4 1 6 8 3、特開 2 0 0 8 - 3 0 0 6 1 1 に記載)により、TFT 及び配線、SD 電極 2 2 からなる TFT 層 8 4 を形成する(図 4 (a))。TFT は、無機 TFT であってもよいし、有機 TFT であってもよい。

【0280】

なお、段差形成部 8 3 が樹脂材料で形成されている場合は、有機 TFT を形成することが好ましい。

40

層間絶縁膜形成工程：

上記 TFT 層 8 4 上に、ポジ型の感光性有機材料からなるレジスト膜を塗布した後、そのレジスト膜の SD 電極 2 2 上に位置する部分にコンタクトホール 9 0 を形成する。

【0281】

レジスト膜は、スピンコート法等の液層成膜法によって塗布され、TFT 層 8 4 上の凹凸が埋まることで表面が平坦化される。

コンタクトホール 1 3 の形成にはフォトリソグラフィ法が用いられる。例えば、モノトーンマスクを用いて、レジスト膜における各コンタクトホール 9 0 の形成予定領域を露光する。その後、現像処理によって、感光部分を除去することでレジスト膜を貫通するコンタクトホール 9 0 が形成される。そして、レジスト膜にコンタクトホール 9 0 が形成され

50

たものが層間絶縁膜 86 となる。

【0282】

その後の処理は前記実施の形態 1 と同様であるので説明を省略する。

本実施の形態では、層間絶縁膜 86 の上面が平坦であり、各色の陽極板 91 が形成される領域の高さが均一になる。よって、陽極板 91、画素規制層 92、ホール注入層 93 等を容易に形成することができる。

【0283】

本実施の形態において、層間絶縁膜 86 の上面のうち、(i) 第 1 面 83a 上に形成された部分(陽極板 91a が形成された部分)が、前記「第 1 電極板群が形成される箇所」に相当し、(ii) 第 2 面 83b 上に形成された部分(陽極板 91b が形成された部分)が、前記「第 2 電極板群が形成される箇所」に相当し、(iii) 第 3 面 83c 上に形成された部分(陽極板 91c が形成された部分)が、前記「第 3 電極板群が形成される箇所」に相当する。

10

【0284】

なお、第 2 面 83b 上に形成された部分が、第 1 電極板群が形成される箇所に相当し、第 3 面 83c 上に形成された部分が、第 2 電極板群が形成される箇所に相当すると考えることもできる。さらに、第 1 面 83a 上に形成された部分 a が、第 1 電極板群が形成される箇所に相当し、第 3 面 83c 上に形成された部分が、第 2 電極板群が形成される箇所に相当すると考えることもできる。

【0285】

また、本実施の形態において、層間絶縁膜 86 の上面のうち、各陽極板 91a, b, c が形成された部分の高さは互いに実質同一とされている(コンタクトホールが形成されている部分を除く)。具体的には、層間絶縁膜 86 の上面のうち、陽極板 91a が形成された部分の高さと陽極板 91c が形成された部分の高さとの差が、第 1 コンタクトホール 87a の深さと第 3 コンタクトホール 87c の深さとの差の 5% 以内にされている。なお、各コンタクトホールの深さは、図 9 に例示する深さ P1 ないし P3 のごとく決定される。

20

【0286】

[その他]

1. 表示装置の構成例

図 13 は、上記表示パネル 100 を用いた表示装置 200 の構成を示す図である。

30

【0287】

図 14 は、表示装置 200 を用いたテレビシステムの一例を示す外観形状である。

表示装置 200 は、有機 EL 表示パネル 100 と、これに接続された駆動制御部 120 とから構成されている。駆動制御部 120 は、4 つの駆動回路 121 ~ 124 と制御回路 125 とから構成されている。駆動制御部 120 には図示を省略する電源供給部から電力が供給される。

【0288】

なお、前記 TFT 層 2 は、行列状に配列された有機 EL 素子 20 の各列に対応する信号線用配線と各行に対応する走査線用配線とを備えている。信号線用配線は、Y 方向に延設され、駆動回路 121 と駆動回路 122 との少なくとも一方に接続されると共に、各列の有機 EL 素子 20 に対応する TFT と接続されている。また、走査線用配線は、X 方向に延設され、駆動回路 123 と駆動回路 124 との少なくとも一方に接続されると共に、各行の有機 EL 素子 20 に対応する TFT と接続されている。

40

【0289】

2. 上記実施の形態および変形例では、本発明の構成および作用・効果を分かりやすく説明するために一例としての各構成を採用するものであり、本発明は、本質的な部分を除き、上記形態に限定されるものではない。例えば、上記実施の形態では、図 1 に示すように、発光層 10 に対し、その Z 軸方向下側に陽極板 5 が配されている構成を一例として採用したが、本発明は、これに限らず有機発光層 10 に対し、その Z 軸方向下側に陰極が配されているような構成を採用することもできる。

50

【 0 2 9 0 】

3. 上記実施の形態および変形例では、陽極板 5 を反射金属とし、陰極層 1 1 を透明もしくは半透明金属としたトップエミッション構造としても良いし、陽極板 5 を透明もしくは半透明金属とし、陰極層 1 1 を反射金属としたボトムエミッション構造としても良い。

【 0 2 9 1 】

4. 上記実施の形態および変形例では、基板上に T F T 層 2 を有するアクティブマトリックス駆動を前提に説明したが、本願はパッシブマトリックス駆動にも適用できる。この場合、T F T 層は必要なく、有機発光層を駆動するための駆動配線によって有機発光層に電流を供給することができる。

【 0 2 9 2 】

5. 上記実施の形態および変形例において、画素規制層 6 が、陽極板 5 とホール注入層 7 との間に形成されていたが、ホール注入層 7 の上に画素規制層 6 を形成してもよい。

6. 上記実施の形態では、陽極板 5 の上方に、有機機能層としてホール輸送層をウェット方式で形成する例を示したが、有機機能層として、ホール注入層、ホール注入兼輸送層をウェット方式で形成する場合も、同様にして、その有機機能層の膜厚を微調節して、各発光色の光を効率よくすることができる。

【 0 2 9 3 】

7. 上記実施の形態および変形例において、ホール輸送層 9 および発光層 1 0 の両方をインクジェット方式で塗布する場合、互いに異なる色のサブピクセル間における膜厚差の調節を、ホール輸送層 9 および発光層 1 0 の 2 つの層で行うことができる。

【 産業上の利用可能性 】

【 0 2 9 4 】

本発明に係る有機 E L 表示パネルは、携帯電話やテレビなどの電子機器のディスプレイとして用いることができる。

【 符号の説明 】

【 0 2 9 5 】

- 1 基板
- 2 T F T 層
- 3 層間絶縁膜
- 5 (5 a ~ 5 c) 陽極板
- 6 画素規制層
- 7 (7 a ~ 7 c) ホール注入層
- 8 a , 8 b , 8 c 隔壁
- 9 (9 a ~ 9 c) ホール輸送層
- 1 0 (1 0 a ~ 1 0 c) 有機発光層
- 1 1 陰極層
- 1 3 (1 3 a ~ 1 3 c) コンタクトホール
- 1 5 (1 5 a ~ 1 5 c) 窪み部
- 2 0 a ~ 2 0 c 有機 E L 素子
- 2 2 S D 電極
- 2 3 (2 3 a ~ 2 3 c) 窪み部
- 1 0 0 有機 E L 表示パネル

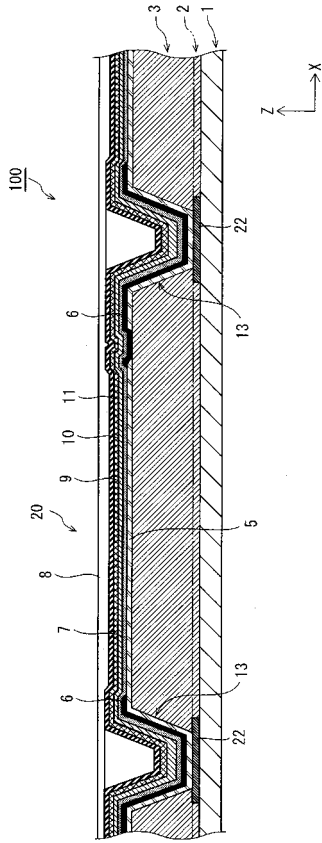
10

20

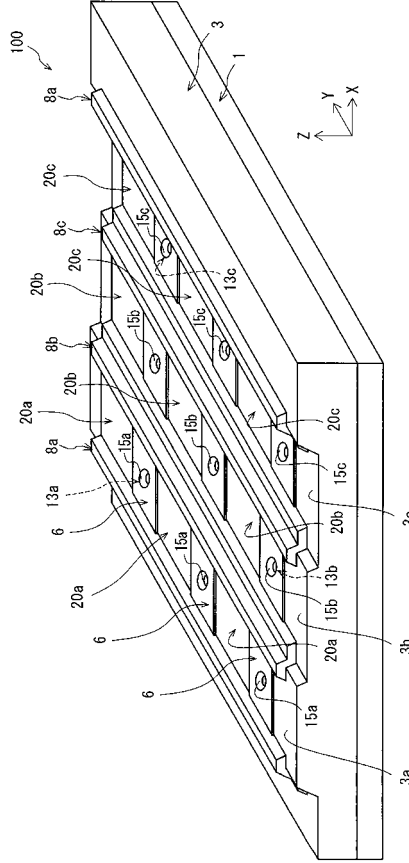
30

40

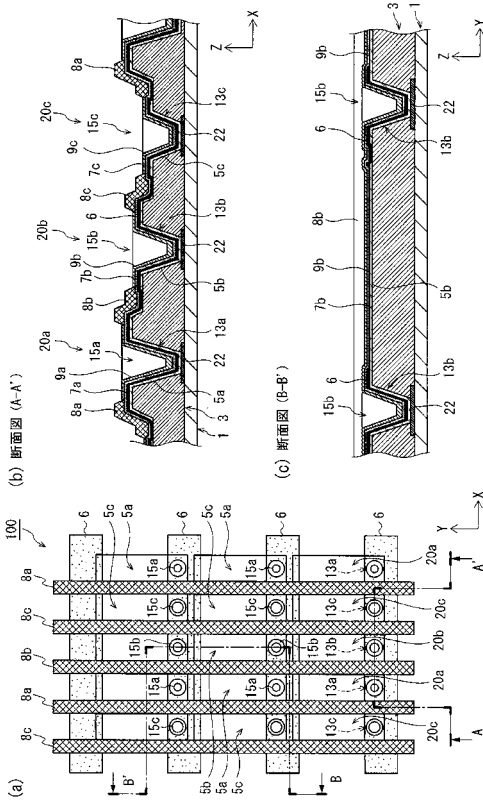
【図1】



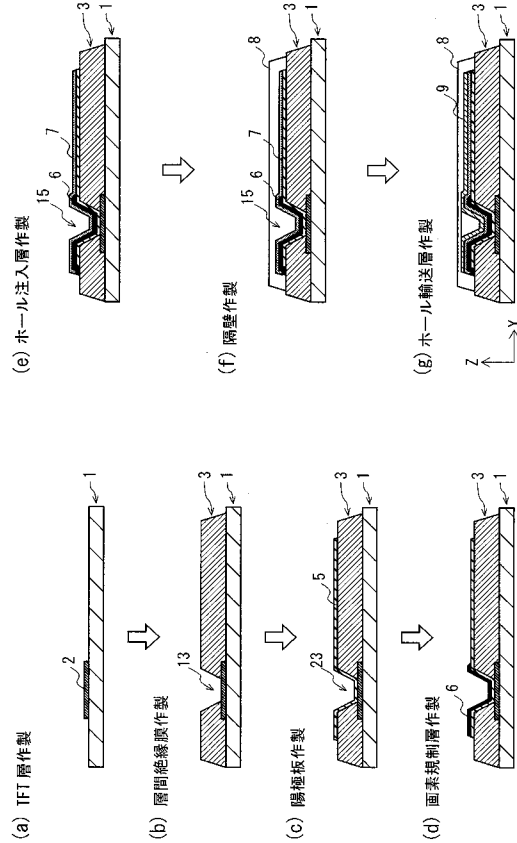
【図2】



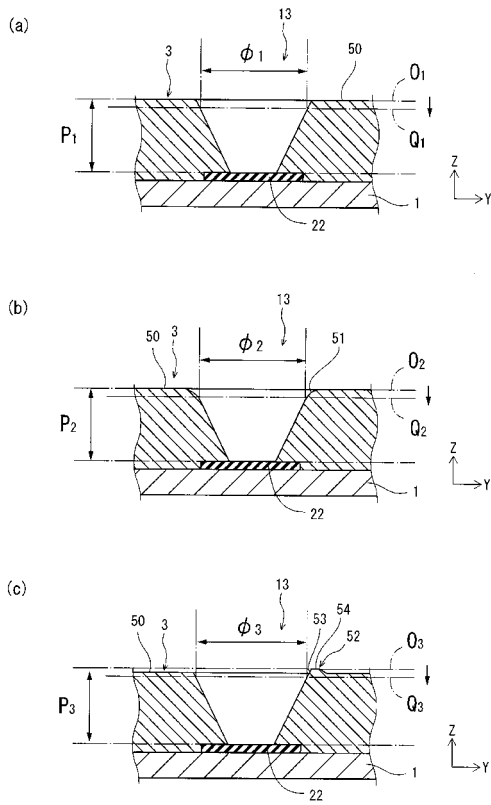
【図3】



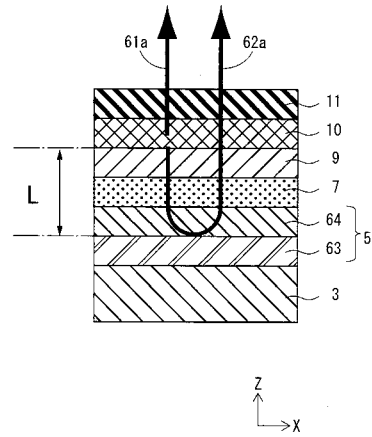
【図4】



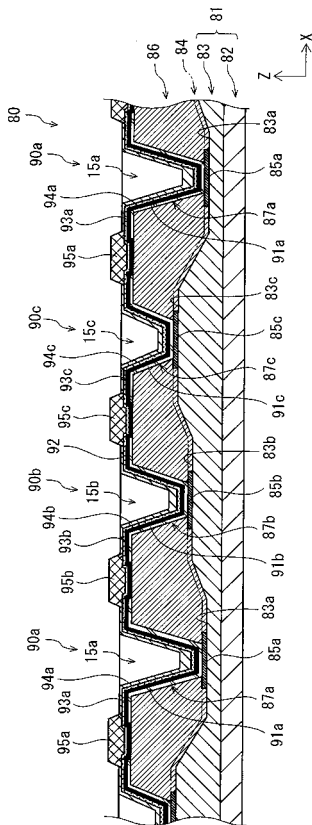
【 図 9 】



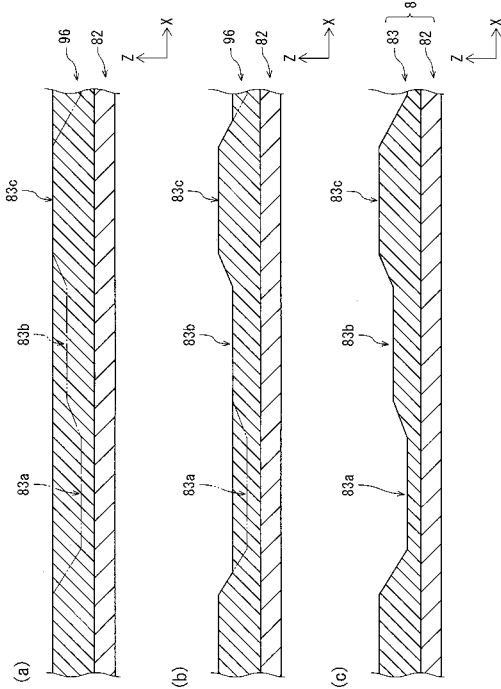
【 図 10 】



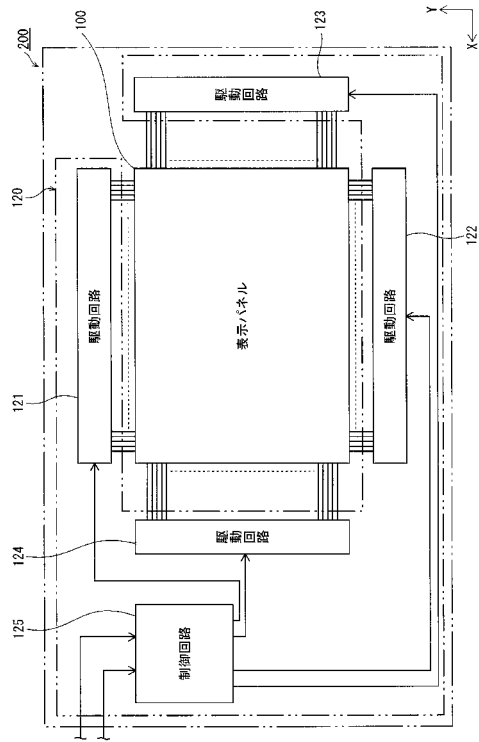
【 図 11 】



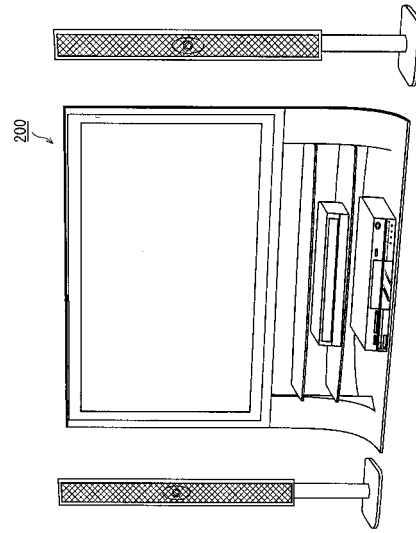
【 図 12 】



【図13】



【図14】



フロントページの続き

(72)発明者 近藤 哲郎
大阪府門真市大字門真1006番地 パナソニック株式会社内

審査官 東松 修太郎

(56)参考文献 特開2010-097697(JP,A)
特開2005-157300(JP,A)
特開2003-022035(JP,A)
国際公開第2009/084209(WO,A1)
特表2004-514265(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
H01L51/50-51/56
H05B 33/00-33/28

专利名称(译)	有机EL显示面板，显示装置和有机EL显示面板的制造方法		
公开(公告)号	JP5462251B2	公开(公告)日	2014-04-02
申请号	JP2011514927	申请日	2010-08-06
[标]申请(专利权)人(译)	松下电器产业株式会社		
申请(专利权)人(译)	松下电器产业株式会社		
当前申请(专利权)人(译)	松下电器产业株式会社		
[标]发明人	西山誠司 近藤哲郎		
发明人	西山 誠司 近藤 哲郎		
IPC分类号	H01L51/50 H05B33/22 H05B33/12 H05B33/10 H05B33/24		
CPC分类号	H01L27/3258 H01L27/3211 H01L27/3246 H01L27/3248 H01L51/5265		
FI分类号	H05B33/14.A H05B33/22.Z H05B33/12.B H05B33/10 H05B33/24		
代理人(译)	中岛四郎 川端弘治 木村浩一		
其他公开文献	JPWO2012017500A1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

提供了一种有机发光显示面板，当通过湿法形成中间层和发光层时，通过调节不同发光颜色的层（例如中间层）之间的膜厚差，可以提高发光效率和发光颜色。通过改变作为有机发光元件的下层的层间绝缘膜的膜厚度，接触孔的体积根据颜色而变化，从而调节每个阳极板中的凹部的体积。当通过喷墨方法喷射包括用于中间层等的材料的墨时，中间层等的膜厚根据凹入的墨量而变化。因此，通过调节不同颜色的凹部之间的体积差，可以精细地调节中间层等之间的膜厚差。

図 1

